This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

33			
	*		
		•	
•	,		
	9-		
		•	
		+	
i.		•	
	-7-2		

- (19)【発行国】日本国特許庁(JP)
- (12)【公報種別】公開特許公報(A)
- (11) 【公開番号】特開平11-97180
- (43) 【公開日】平成11年(1999) 4月9日
- (54) 【発明の名称】有機電界発光楽子
- (51) 【国際特許分類第6版】

H058 33/14

CO9K 11/06

HO5B 33/22

- [FI] |
 - HO5B 33/14

CO9K 11/06 Z

HO5B 33/22

В

- 【審査請求】未請求
- 【請求項の数】6

【出願形態】OL

【全頁数】19

- (21)【出願番号】特願平9-258971
- (22) 【出願日】平成9年(1997)9月24日
- (71) 【出願人】

【識別番号】000005887

【氏名又は名称】三井化学株式会社

【住所又は居所】東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

- (19) [Publication Office] Japanese Patent Office (JP)
- (12) [Kind of Document] Japan Unexamined Patent Publication (A)
- (11) [Publication Number of Unexamined Application] Japan U nexamined Patent Publication Hei 11 - 97180
- (43) [Publication Date of Unexamined Application] 1999 (199 9) April 9 day
- (54) [Title of Invention] ORGANIC ELECTROLUMINESCEN T ELEMENT
- (51) [International Patent Classification 6th Edition]

H05B 33/14

C09K 11/06

H05B 33/22

[FI]

H05B 33/14 В

В

C09K 11/06

H05B 33/22

D

[Request for Examination] Examination not requested

[Number of Claims] 6

[Form of Application] OL

[Number of Pages in Document] 19

(21) [Application Number] Japan Patent Application Hei 9 - 25

8971

- (22) [Application Date] 1997 (1997) September 24 day
- (71) [Applicant]

[Applicant Code] 000005887

[Name] MITSUI CHEMICALS INC. (DB 69-056-7037)

[Address] Tokyo Chiyoda-ku Kasumigaseki 3-Chome 2-5

JP 99097180A Machine Translation

(72) 【発明者】

【氏名】西本 泰三

【住所又は居所】神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井東圧化学株式会社内

(72) 【発明者】

【氏名】三沢 伝美

【住所又は居所】神奈川県横浜市栄区笠間町 1 1 9 0番地 三井東圧化学株式会社内

(72) 【発明者】

【氏名】杉本 賢一

【住所又は居所】神奈川県横浜市栄区笠間町 1 1 9 0 番地 三井東圧化学株式会社内

(72)【発明者】

【氏名】塚原 宇

【住所又は居所】神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井東圧化学株式会社内

(72)【発明者】

【氏名】詫摩 啓輔

【住所又は居所】神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井東圧化学株式会社内

(72) 【発明者】

【氏名】中塚 正勝

【住所又は居所】神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 (57) 【要約】

【解決手段】 一対の電極間に、ベンゾピロメテン系化合物を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。

【効果】 発光輝度が優れた有機電界発光素子を提供する。

(72) [Inventor]

[Name] Nishimoto Taizo

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Sakaeku Kasama-cho 119 0 Mitsui Toatsu Chemicals Inc. (DB 69-053-6982)

(72) [Inventor]

[Name] Misawa transmission beauty

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Sakaeku Kasama-cho 119 0 Mitsui Toatsu Chemicals Inc. (DB 69-053-6982)

(72) [Inventor]

[Name] Sugimoto Kenichi

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Sakaeku Kasama-cho 119 0 Mitsui Toatsu Chemicals Inc. (DB 69-053-6982)

(72) [Inventor]

[Name] Tsukahara space/large house

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Sakaeku Kasama-cho 119 0 Mitsui Toatsu Chemicals Inc. (DB 69-053-6982)

(72) [Inventor]

[Name] Takuma Keisuke

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Sakaeku Kasama-cho 119 0 Mitsui Toatsu Chemicals Inc. (DB 69-053-6982)

(72) [Inventor]

[Name] Nakatsuka Masakatsu

(57) [Abstract]

[Means of Solution] Between pair of electrodes, at least one la yer clamping doing layer which at least 1 kind contains, the benzo pyro methene compound, organic electroluminescent element which becomes.

[Effect(s)] Organic electroluminescent element where light emission luminance is superior is offered.

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の電極間に、下記一般式(1)(化1)で表される化合物を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。

【化1】 1

$$R_7$$
 R_8
 R_5
 R_4
 R_3
 R_2
 R_9
 R_{10}
 R_{11}
 R_{11}
 R_{12}
 R_{13}
 R_{14}
 R_{15}
 R_{15}

[式中、R₁、R₂、R₃、R₅、R₆、R₇、R₈、R 。はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、 アルキル基、ハロゲノアルキル基、アルコキシアルキル基、 アルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、アリールオキシ基 アシル基、アルコキシカルポニル基、ジアルキルアミノカ ルボニル基、アルキルカルボニルアミノ基、アリールカルボ ニルアミノ基、アリールアミノカルポニル基、アリールオキ シカルポニル基、アラルキル基、炭素環式アリール基、複素 環式アリール基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルケ ニルオキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基、 アルコキシカルボニルアルコキシカルボニル基、アルキルカ ルポニルアルコキシカルポニル基、ジ(アルコキシアルキル)アミノカルボニル基、またはアルケニル基を表し、R₄ は 水素原子、シアノ基、アルキル基、アラルキル基、炭素環式 アリール基、複素環式アリール基、またはアルケニル基を表 し、 R_{10} および R_{11} はフッ素原子、アルキル基、アルコキシ 基、アラルキル基、炭素環式アリール基、または複素環式ア リール基を表す〕

【請求項2】 一般式(1)で表される化合物を含有する層が、発光層である請求項1記載の有機電界発光素子。

【請求項3】 一般式(1)で表される化合物を含有する層が、電子注入輸送層である請求項1記載の有機電界発光素子

【請求項4】 一般式(1)で表される化合物を含有する層

[Claim(s)]

[Claim 1]. Between pair of electrodes, at least one layer clamping doing layer which at least 1 kind contains, the compound which is displayed with below-mentioned General Formula (1) (Chemical formula 1), organic electroluminescent element which becomes.

[Chemical Formula 1]

(The inside of Formula, R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, As for R9 to respective independence, hydrogen atom, halogen atom, cyano group, alkyl group, halogeno alkyl group, alkoxy alkył group, alkoxy group, alkoxy group, aryloxy group, acyl group, alkoxy carbonyl group, dialkyl amino carbonyl group, alkyl carbonyl amino group, aryl carbonyl amino group, aryl amino carbonyl group, aryloxy carbonyl group, aralkyl group, the carbocyclic aryl group, heterocyclic aryl group, alkyl thio group, aryl thio group, alkenyl oxycarbonyl group, aralkyloxy carbonyl group, the alkoxy carbonyl alkoxy carbonyl group, alkyl carbonyl alkoxy carbonyl group, di (alkoxy alkyl) amino carbonyl group or alkenyl group are displayed, R4displays hydrogen atom, cyano group, alkyl group, aralkyl group, carbocyclic aryl group, the heterocyclic aryl group or alkenyl group, R10 and R11 displays fluorine atom, alkyl group, the alkoxy group, aralkyl group, carbocyclic aryl group or heterocyclic aryl group)

[Claim 2] Layer which contains compound which is displayed with General Formula (1), the organic electroluminescent element which is stated in Claim 1 which is a luminescent layer.

[Claim 3] Layer which contains compound which is displayed with General Formula (1), the organic electroluminescent element which is stated in Claim 1 which is a electronimplanted transport layer.

[Claim 4] Layer which contains compound which is displayed

JP 99097180A Machine Translation

が、さらに発光性有機金属錯体を含有する請求項1~3のいずれかに配載の有機電界発光素子。

【請求項5】 一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送層を 有する請求項1~4のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項6】 一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を 有する請求項1~5のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子に関 する。

[0002]

【従来の技術】従来、無機電界発光素子は、例えば、バック ライトなどのパネル型光源として使用されてきたが、該発光 素子を駆動させるには、交流の高電圧が必要である。最近に なり、発光材料に有機材料を用いた有機電界発光素子(有機 エレクトロルミネッセンス素子:有機EL索子) が開発され た [Appl. Phys. Lett., 51 、913 (1987)] 。有機電界発 光素子は、蛍光性有機化合物を含む薄膜を、陽極と陰極間に 挟持された構造を有し、該薄膜に電子および正孔(ホール) を注入して、再結合させることにより励起子(エキシトン) を生成させ、この励起子が失活する際に放出される光を利用 して発光する索子である。有機電界発光素子は、数V~数十 ∨程度の直流の低電圧で、発光が可能であり、また蛍光性有 機化合物の種類を選択することにより、種々の色(例えば、 赤色、青色、緑色)の発光が可能である。このような特徴を 有する有機電界発光素子は、種々の発光素子、表示素子等へ の応用が期待されている。しかしながら、一般に、発光輝度 が低く、実用上充分ではない。

【0003】発光輝度を向上させる方法として、発光層として、例えば、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウムをホスト化合物とし、クマリン誘導体、ピラン誘導体をゲスト化合物(ドーパント)として用いた有機電界発光素子が提案されている〔J. Appl. Phys., 65、3610 (1989)〕。また、発光層として、トリス(8ーキノリノラート)アルミニ

with General Formula (1), furthermore organic electroluminescent element which is stated in any of Claim 1 to 3 which contains luminescent organometallic complex.

[Claim 5] Between pair of electrodes, furthermore, organic electroluminescent element which is stated in any of Claims 1 through 4 which possesses positive hole injection transport layer.

[Claim 6] Between pair of electrodes, furthermore, organic electroluminescent element which is stated in any of Claims 1 through 5 which possesses electron-implanted transport layer.

[Description of the Invention]

[0001]

[Technological Field of Invention] This invention regards organic electroluminescent element.

[0002]

[Prior Art] Until recently, inorganic electroluminescent elemen t was used as for example backlight or other panel type light source, but the said luminescent element is driven, high voltage of alternating current is necessary. Recent, organic electroluminescent element (organic electroluminescent element: organic electroluminescent element) which uses organic material for light-emitting material was developed(Applied Physics Letters, 51 and 913 (1987)). organic electroluminescent element, thin film which includes fluorescence organic compound, having structure which the clamping is done between anode and cathode, filling electronand positive hole (hole) in said thin film, forming exciton (エキシ ton) by recombination doing, when this exciton inactivation doing, it is a element which light emitting is donemaking use of light which is discharged. As for organic electroluminescent element, with low voltage of direct current of several V to several tens V extent, light emitting is possible, light emitting of various color (for example red color, blue and green color) is possible by inaddition selecting types of fluorescence organic compound. As for organic electroluminescent element which possesses this kind of feature, application to the various luminescent element and display element etc is expected. But, generally, light emitting brightness is low, in regard to utility it is not asatisfactory.

[0003] for example tris (8 - quinolinolato) aluminum is designa ted as host compound light emitting brightness as method whichimproves, as luminescent layer, organic electroluminescent element which uses coumarin derivative and pyran derivativeas guest compound (dopant) is proposed (Journal of Applied Physics (0021-8979, JAPIAU), 65, 3610

ウムをホスト化合物とし、ピロメテン誘導体(例えば、1.3、5、7、8ーペンタメチルー4、4ージフルオロー4ーボラー3 a、4 a ージアザーsーインダセン)をゲストト開発として用いた有機電界発光素子が提案されている(特開教として用いた有機電界発光素子が提案されているといるという。 放公報に配載されているピロメテン誘導体を使用すると、発光色は緑ないい黄緑色であり、また充分な発光輝度を有しているとは言いよいであり、また充分な発光輝度を有しているとは言いよいであり、また充分には、特開平9ー118880号、1、8ーペンタメチルー4、4ージフルオロー4ーボ電に記載されているよどロメテン誘導体(例えば、1、3、5、7、8ーペンタメチルー4、4ージフルオロー4ーボ電に記載されているよどもというを含有する層に見いる。1、8ーペンタメチルー4、4ージフルオロー4ーボ電に引きる方を使用によりとの密着性は乏しく、長期間の使用には、その改良が必要であることが判明した。現在で限しては、その改良が必要であることが判明した。現在では、その改良が必要であることが判明した。現在で発光し、自つ、高輝度に発光する有機電界発光素子が望まれている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、発光効率に優れ、高輝度に発光する有機電界発光素子を提供することである。|

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、有機電界発光 素子に関して鋭意検討した結果、本発明を完成するに至った 。すなわち、本発明は、

一対の電極間に、下記一般式(1)(化2)で表される化 合物を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層挟持し てなる有機電界発光素子、

一般式(1)で表される化合物を含有する層が、発光層で ある記載の有機電界発光素子、

一般式 (1) で表される化合物を含有する層が、電子注入 輸送層である記載の有機電界発光素子、

一般式 (1) で表される化合物を含有する層が、さらに発 光性有機金属錯体を含有する前記~のいずれかに記載の有機 電界発光素子、 (1989)). In addition, tris (8 - quinolinolato) aluminum is designated as host compound as luminescent layer, theorganic electroluminescent element which uses pyro methene derivative (for example 1,3,5,7,8 - pentamethyl - 4, 4-di fluoro - 4 - bora - 3a,4a-di aza - s - indacene) as guest compound is proposed, (Japan Unexamined Patent Publication Hei 9-118880 disclosure). But, when pyro methene derivative which is stated in said disclosure is used, emission colorwas green or yellow green, in addition has possessed satisfactory light emitting brightness withit is difficult saying was ascertained. Furthermore, adhesion of layer and electrode (for example cathode) which contain pyro methene derivative (for example 1,3,5,7,8 - pentamethyl - 4, 4-di fluoro - 4 bora - 3a,4a-di aza - s - indacene) which is stated in Japan Unexamined Patent Publication Hei 9 - 118880 disclosure is scanty, improvement beingnecessary at time of use of long period, was ascertained. Presently, light emitting it does in amber color or red color, organic electroluminescent elementwhich light emitting is done is desired to and high brightness.

[0004]

[Problems to be Solved by the Invention] Problem of this invention is superior in light emission efficiency, it is to offer theorganic electroluminescent element which light emitting is done in high brightness.

[0005]

[Means to Solve the Problems] This inventor etc, result of dilig ent investigation, this invention reached to completion inregard to organic electroluminescent element. As for namely, this invention,

Between pair of electrodes, at least one layer clamping doing l ayer which at least 1 kind contains,the compound which is displayed with below-mentioned General Formula (1) (Chemical formula 2), organic electroluminescent element which becomes,

Layer which contains compound which is displayed with Gener al Formula (1), is luminescent layer organic electroluminescent element which is stated,

Layer which contains compound which is displayed with Gener al Formula (1), is electron-implanted transport layer organic electroluminescent element which is stated,

Layer which contains compound which is displayed with Gener al Formula (1), furthermore organic electroluminescent element which is stated in any of theaforementioned to which contains luminescent organometallic complex,

一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送層を有する前記~ のいずれかに記載の有機電界発光素子、

ー対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する前記~ のいずれかに配載の有機電界発光素子、に関するものである

[0006]

【化2】

$$R_{1}$$
 R_{1}
 R_{1}
 R_{2}
 R_{1}
 R_{1}
 R_{1}
 R_{1}
 R_{1}
 R_{1}
 R_{2}
 R_{1}

[式中、R₁、R₂、R₃、R₅、R₆、R₇、R₈、R $_{\rm g}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、 アルキル基、ハロゲノアルキル基、アルコキシアルキル基、 アルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、アリールオキシ基 、アシル基、アルコキシカルボニル基、ジアルキルアミノカ ルボニル基、アルキルカルボニルアミノ基、アリールカルボ ニルアミノ基、アリールアミノカルボニル基、アリールオキ シカルボニル基、アラルキル基、炭素環式アリール基、複素 環式アリール基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルケ ニルオキシカルポニル基、アラルキルオキシカルポニル基、 アルコキシカルボニルアルコキシカルボニル基、アルキルカ ルボニルアルコキシカルボニル基、ジ(アルコキシアルキル) アミノカルボニル基、またはアルケニル基を表し、R₄ は 水素原子、シアノ基、アルキル基、アラルキル基、炭素環式 アリール基、複素環式アリール基、またはアルケニル基を表 し、 R_{10} および R_{11} はフッ素原子、アルキル基、アルコキシ 基、アラルキル基、炭素環式アリール基、または複素環式ア リール基を表す〕

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明に関して詳細に説明する。本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に、前記一般式 (1) で表されるペンゾピロメテン系化合物を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層挟持してなるものである。前記一般式 (1) で表されるペンゾピロメテン系化合物において、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_5 、 R_6 、 R_7 、 R_8 、 R_9 はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、アルキル基、ハロゲノアルキル基、アルコキシアルキャ基、アリールオキシ基

Between pair of electrodes, furthermore, organic electrolumin escent element which is stated in any of aforementioned to which possesses positive hole injection transport layer,

Between pair of electrodes, furthermore, organic electrolumin escent element which is stated in any of aforementioned to which possesses electron-implanted transport layer, it is somethingregarding.

[0006]

[Chemical Formula 2]

(The inside of Formula, R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, A s for R9 to respective independence, hydrogen atom, halogen atom, cyano group, alkyl group, halogeno alkyl group, alkoxy alkył group, alkoxy group, alkoxy alkoxy group, aryloxy group, acyl group, alkoxy carbonyl group, dialkyl amino carbonyl group, alkyl carbonyl amino group, aryl carbonyl amino group, aryl amino carbonyl group, aryloxy carbonyl group , $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right)$ aralkyl group , the carbocyclic aryl group , heterocyclic aryl group, alkyl thio group, aryl thio group, alkenyl oxycarbonyl group, aralkyloxy carbonyl group, the alkoxy carbonyl alkoxy carbonyl group, alkyl carbonyl alkoxy carbonyl group, di (alkoxy alkyl) amino carbonyl group or alkenyl group are displayed, R4displays hydrogen atom, cyano group, alkyl group, aralkyl group, carbocyclic aryl group, the heterocyclic aryl group or alkenyl group, R10 and R11 displays fluorine atom, alkyl group, the alkoxy group, aralkyl group, carbocyclic aryl group or heterocyclic aryl group)

[0007]

[Embodiment of Invention] You explain in detail below, in regard to this invention. organic electroluminescent element of this invention, between pair of electrodes, at least one layer clamping doing layerwhich at least 1 kind contains, benzo pyro methene compound which is displayed with theaforementioned General Formula (1), is something which becomes. In benzo pyro methene compound which is displayed with aforementioned General Formula (1)putting, R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, As for R9 to respective independence,

、アシル基、アルコキシカルボニル基、ジアルキルアミノカルボニル基、アルキルカルボニルアミノ基、アリールカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニル基、アラルキル基、炭素環式アリール基、複素環式アリール基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルケニルオキシカルボニルを、アラルキルオキシカルボニルアルコキシカルボニルを、アルキルカルボニルアルコキシカルボニル基、ジ(アルコキシアルキルカルボニルアルコキシカルボニル基、ジ(アルコキシアルキル)アミノカルボニル基、またはアルケニル基を表し、好ましくは、水素原子、アルキル基、炭素環式アリール基を表す。

 $\{0\,0\,0\,8\}$ R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_5 、 R_6 、 R_7 、 R_8 および R_5 の具体例としては、水素原子:フッ素、塩素、臭 素、ヨウ素のハロゲン原子 ; シアノ甚 ; 例えば、メチル基、 エチル基、n-プロピル基、iso-プロピル基、n-ブチル基、i so-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、 iso-ペンチル基、2-メチルブチル基、1-メチルブチル基、n eo-ペンチル基、1,2-ジメチルプロピル基、1,1-ジメチルプ ロビル基、cyclo-ペンチル基、n-ヘキシル基、4-メチルペン チル基、3-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、1-メチ. ルペンチル基、3,3-ジメチルブチル基、2,3-ジメチルブチル 基、1,3-ジメチルブチル基、2,2-ジメチルブチル基、1,2-ジ メチルプチル基、1.1-ジメチルブチル基、3-エチルブチル基 、2-エチルブチル基、1-エチルブチル基、1,2,2-トリメチル ブチル基、1,1,2-トリメチルブチル基、1-エチル-2- メチル プロビル基、cyclo-ヘキシル基、n-ヘプチル基、2-メチルヘ キシル基、3-メチルヘキシル基、4-メチルヘキシル基、5-メ チルヘキシル基、2.4-ジメチルペンチル基、n-オクチル基、 2-エチルヘキシル基、2,5-ジメチルヘキシル基、2,5,5-トリ メチルベンチル基、2,4-ジメチルヘキシル基、2,2,4-トリメ チルベンチル基、n-ノニル基、3.5.5-トリメチルヘキシル基 、n-デシル基、4-エチルオクチル基、4-エチル-4,5- ジメチ ルヘキシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、1.3.5.7-テ トラメチルオクチル苺、4-ブチルオクチル苺、6,6-ジエチル オクチル基、n-トリデシル基、6-メチル-4- ブチルオクチル . 基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシル基、3,5-ジメチルへ プチル基、2.6-ジメチルヘプチル基、2.4-ジメチルヘプチル 基、2,2,5,5-テトラメチルヘキシル基、1-cyclo-ペンチル -2.2- ジメチルプロピル基、1-cyclo-ヘキシル-2.2- ジメ チルプロピル基等の直鎖、分岐または環状のアルキル基:

【0009】例えば、クロロメチル基、ジクロロメチル基、 フルオロメチル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロ メチル基、ペンタフルオロエチル基、ノナフルオロブチル基 等のハロゲノアルキル基:例えば、メトキシエチル基、エト キシエチル基、iso-プロビルオキシエチル基、3-メトキシプ hydrogen atom, halogen atom, cyano group, alkyl group, halogeno alkyl group, alkoxy alkyl group, the alkoxy group, alkoxy group, aryloxy group, acyl group, alkoxy carbonyl group, dialkyl amino carbonyl group, the alkyl carbonyl amino group, aryl carbonyl amino group, aryl carbonyl group, aryl group, aryloxy carbonyl group, aralkyl group, carbocyclic aryl group, the heterocyclic aryl group, alkyl thio group, aryl thio group, alkenyl oxycarbonyl group, aralkyloxy carbonyl group, alkoxy carbonyl group, the alkyl carbonyl alkoxy carbonyl group, di (alkoxy alkyl) amino carbonyl group or alkenyl group are displayed, preferably, hydrogen atom, the alkyl group and carbocyclic aryl group are displayed.

[0008] As embodiment of R1 , R2 , R3 , R5 , R6 ,the R7 and R8 and R9, hydrogen atom; halogen atom of fluorine, chlorine, bromine and iodine; cyano group; for example methyl group, ethyl group, n-propyl group, iso-propyl group, n-butyl group, iso-butyl group, s-butyl group, tbutyl group, n-pentyl group, iso-pentyl group, 2-methyl butyl group, 1- methyl butyl group, neo-pentyl group, 1, 2dimethyl propyl group, 1, 1-dimethyl propyl group, cyc lopentyl group, n-hexyl group, 4-methyl pentyl group, 3methyl pentyl group, 2- methyl pentyl group, 1- methyl pentyl group, 3, 3-dimethylbutyl group, 2, 3-dimethylbutyl group, 1, 3-dimethylbutyl group, 2, 2-dimethylbutyl group, 1, 2-dimethylbutyl group, 1, 1-dimethylbutyl group, 3-ethyl butyl group, 2- ethyl butyl group, 1- ethyl butyl group, 1,2,2trimethyl butyl group, 1,1,2-trimethyl butyl group, alkyl group of 1-ethyl-2- methyl propyl group, cyc lo-hexyl group, n-heptyl group, 2-methyl hexyl group, 3-methyl hexyl group, 4- methyl hexyl group, 5- methyl hexyl group, 2, 4- dimethyl pentyl group, n-octyl group, 2- ethylhexyl group, 2,5- dimethyl hexyl group, 2,5,5- trimethyl pentyl group, 2, 4- dimethyl hexyl group, 2,2, 4- trimethyl pentyl group, n-nonyl group, 3,5,5- trimethyl hexyl group, ndecyl group, 4- ethyl octyl group, 4- ethyl-4,5- dimethyl hexyl group, n-undecyl group, n-dodecyl group, 1,3,5,7tetramethyl octyl group, 4- butyl octyl group, 6,6- diethyl octyl group, n-tridecyl group, 6-methyl-4- butyl octyl group, n-tetradecyl group, n-pentadecyl group, 3,5dimethyl heptyl group, 2,6-dimethyl heptyl group, 2,4dimethyl heptyl group, 2,2,5,5- tetramethyl hexyl group, 1cyc lo-pentyl-2, 2- dimethyl propyl group, 1-cyc lo-hexyl-2, 2- dimethyl propyl group or other straight chain and branched or cyclic;

[0009] For example chloromethyl group, dichloro methyl group, fluoromethyl group, trifluoromethyl group, penta fluoromethyl group, pentafluoroethyl group and nonafluorobutyl group or other halogeno alkyl group; for example methoxyethyl group, ethoxyethyl group, iso-propyl

ロビル基、2-メトキシブチル基等のアルゴキシアルキル基: 例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、iso-ブ ロポキシ基、n-ブトキシ基、iso-ブトキシ基、sec-ブトキシ .. 甚、t-ブトキシ甚、n-ペントキシ甚、iso-ペントキシ甚、n -eo-ペントキシ甚、n-ヘキシルオキシ甚、nードデシルオキ シ基等のアルコキシ基;例えば、メトキシエトキシ基、エト キシエトキシ基、3-メトキシブロビルオキシ基、3-(iso- ブ ロビルオキシ) プロビルオキシ基等のアルコキシアルコキシ 基:例えば、フェノキシ基、2-メチルフェノキシ基、4-メチ ルフェノキシ基、4-t-ブチルフェノキシ基、2-メトキシフェ ノキシ基、4-iso-プロビルフェノキシ基等のアリールオキシ 基:例えば、ホルミル基、アセチル基、エチルカルボニル基、 n-プロピルカルボニル甚、iso-プロピルカルボニル基、n-ブ チルカルポニル基、iso-ブチルカルポニル基、sec-ブチルカ ルポニル基、t-ブチルカルポニル基、n-ペンチルカルボニル 基、iso-ペンチルカルボニル基、neo-ペンチルカルボニル基 、2-メチルブチルカルボニル基、ニトロベンジルカルボニル 基等のアシル基:例えば、メトキシカルポニル基、エトキシ カルポニル基、イソプロピルオキシカルポニル基、2.4-ジメ チルブチルオキシカルボニル基等のアルコキシカルボニル基

【0010】例えば、ジメチルアミノカルボニル基、ジエチ ルアミノカルポニル基、ジ-n- プロピルアミノカルポニル基 、ジ-n- ブチルアミノカルポニル基、N-メチル-N- シクロへ キシルアミノカルボニル基等のジアルキルアミノカルボニル 基:例えば、アセチルアミノ基、エチルカルポニルアミノ基 、ブチルカルボニルアミノ基等のアルキルカルボニルアミノ 基 ; 例えば、フェニルアミノカルポニル基、4-メチルフェニ ルアミノカルポニル基、2-メトキシフェニルアミノカルポニ ル基、4-n-プロピルフェニルアミノカルボニル基等のアリー ルアミノカルボニル基:例えば、フェニルカルボニルアミノ基 、4-エチルフェニルカルボニルアミノ基、3-ブチルフェニル カルボニルアミノ基等のアリールカルポニルアミノ基:例えば 、フェノキシカルボニル基、2-メチルフェノキシカルボニル 基、4-メトキシフェノキシカルボニル甚、4-t-ブチルフェノ キシカルボニル基等のアリールオキシカルボニル基:例えば、 ペンジル基、ニトロペンジル基、シアノペンジル基、ヒドロ キシベンジル基、メチルベンジル基、ジメチルベンジル基、 トリメチルベンジル基、ジクロロベンジル基、メトキシベン ジル基、エトキシベンジル基、トリフルオロメチルベンジル 基、ナフチルメチル基、ニトロナフチルメチル基、シアノナ フチルメチル基、ヒドロキシナフチルメチル基、メチルナフ チルメチル基、トリフルオロメチルナフチルメチル基等のア ラルキル基:

【0011】例えば、フェニル基、ニトロフェニル基、シアノフェニル基、ヒドロキシフェニル基、メチルフェニル基、 ジメチルフェニル基、トリメチルフェニル基、ジクロロフェニル基、メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、トリフルオロメチルフェニル基、N,N-ジメチルアミノフェニル基、 oxyethyl group, 3- methoxypropyl group, 2- methoxybutyl group or other alkoxy alkyl group; for example methoxy group, ethoxy group, n-propoxy group, iso-propoxy group, n-butoxy group, iso-butoxy group, s-butoxy group, tbutoxy group, n-pentoxy group, iso-pentoxy group, neopentoxy group, n-hexyloxy group and n-dodecyl oxy group or other alkoxy group; for example methoxy ethoxy group, ethoxy ethoxy group, 3-methoxypropyl oxy group and 3-(iso-propyl oxy) propyl oxy group or other alkoxy alkoxy group; for example phenoxy group, 2- methyl phenoxy group, 4- methyl phenoxy group, 4- t-butyl phenoxy group, 2- methoxy phenoxy group, 4- iso- propyl phenoxy group or other aryloxy group; for example formyl group, acetyl group, ethyl carbonyl group, n-propyl carbonyl group, iso-propyl carbonyl group, n-butyl carbonyl group, iso-butyl carbonyl group, s-butyl carbonyl group, t-butyl carbonyl group, npentyl carbonyl group, iso-pentyl carbonyl group, neo-pentyl carbonyl group, 2- methyl butyl carbonyl group and nitrobenzyl carbonyl group or other acyl group; for example methoxycarbonyl group, ethoxy carbonyl group, isopropyl oxycarbonyl group and 2, 4- dimethylbutyl oxycarbonyl group or other alkoxy carbonyl group;

[0010] For example dimethylamino carbonyl group, diethyl a mino carbonyl group, di-n-propylamino carbonyl group, di-nbutyl amino carbonyl group and N- methyl- N- cyclohexyl amino carbonyl group or other dialkyl amino carbonyl group; for example acetylamino group, ethyl carbonyl amino group and butyl carbonyl amino group or other alkyl carbonyl amino group; for example phenylamino carbonyl group, 4methylphenyl amino carbonyl group, 2- methoxyphenyl amino carbonyl group, 4-n-propyl phenylamino carbonyl group or other aryl amino carbonyl group; for example phenyl carbonyl amino group, 4- ethyl phenyl carbonyl amino group, 3- butyl phenyl carbonyl amino group or other aryl carbonyl amino group; for example phenoxy carbonyl group, 2methyl phenoxy carbonyl group, 4- methoxy phenoxy carbonyl group, 4- t-butyl phenoxy carbonyl group or other aryloxy carbonyl group; for example benzyl group, nitrobenzyl group, cyano benzyl group, hydroxy benzyl group, methylbenzyl group, dimethyl benzyl group, trimethyl benzyl group, dichloro benzyl group, methoxy benzyl group, ethoxy benzyl group, trifluoromethyl benzyl group, naphthyl methyl group, nitro naphthyl methyl group, cyano naphthyl methyl group, hydroxy naphthyl methyl group, methyl naphthyl methyl group and trifluoromethyl naphthyl methyl group or other aralkyl group;

[0011] For example phenyl group , nitrophenyl group , cyano phenyl group , hydroxyphenyl group , methyl phenyl group , dimethylphenyl group , trimethyl phenyl group , dichlorophenyl group , methoxyphenyl group , ethoxy phenyl group , trifluoromethyl phenyl group , N, N- dimethylanuno

ナフチル基、ニトロナフチル基、シアノナフチル基、ヒドロ キシナフチル基、メチルナフチル基、トリフルオロメチルナ フチル基等の炭素環式アリール基:例えば、ピロリル基、チエ ニル基、フラニル基、オキサゾイル基、イソオキサゾイル基 、オキサジアソイル基、イミダソイル基、ペンソオキサゾイ ル基、ペンゾチアゾイル基、ペンゾイミダゾイル基、ペンゾ フラニル基、インドイル基等の複素環式アリール基:例えば 、メチルチオ基、エチルチオ基、n-プロピルチオ基、iso-ブ ロピルチオ基、n-ブチルチオ基、iso-ブチルチオ基、sec-ブ チルチオ基、t-ブチルチオ基、n-ペンチルチオ基、iso-ペン チルチオ基、2-メチルブチルチオ基、1-メチルブチルチオ基 、neo-ペンチルチオ基、1,2-ジメチルプロピルチオ基、1.1 -ジメチルプロピルチオ基等のアルキルチオ基: 例えば、フェ ニルチオ基、4-メチルフェニルチオ基、2-メトキシフェニル チオ基、4-t-プチルフェニルチオ基等のアリールチオ基:例 えば、アリルオキシカルボニル基、2-ブテノキシカルボニル 基等のアルケニルオキシカルボニル基:例えば、ペンジルオ キシカルポニル基、フェネチルオキシカルボニル基等のアラ ルキルオキシカルボニル基:

【〇〇12】例えば、メトキシカルボニルメトキシカルボニ ル基、エトキシカルボニルメトキシカルボニル基、nープロボ キシカルポニルメトキシカルボニル基、イソポウロポキシカ ルボニルメトキシカルボニル基等のアルコキシカルボニルア ルコキシカルポニル基:例えば、メチルカルポニルメトキシ カルボニル基、エチルカルボニルメトキシカルボニル基等の アルキルカルボニルアルコキシカルボニル基:例えば、ジ(メトキシエチル)アミノカルボニル基、ジ(エトキシメチル) アミノカルボニル基、ジ(エトキシエチル) アミノカルボ ニル基、ジ(プロポキシエチル)アミノカルボニル基等のジ (アルコキシアルキル) アミノカルボニル基: 例えば、ビニ ル基、プロペニル基、1-ブテニル基、iso-ブテニル基、1-ペ ンテニル基、2-ペンテニル基、2-メチル-1- ブテニル基、3 -メチル-1- ブテニル基、2-メチル-2- ブテニル基、2,2-ジ シアノビニル基、2-シアノ-2- メチルカルボキシルビニル基 、2-シアノ-2- メチルスルホンピニル基等のアルケニル基を 挙げることが!できる。

【0013】 R_4 は水素原子、シアノ基、アルキル基、アラルキル基、炭素環式アリール基、複素環式アリール基、またはアルケニル基を表し、好ましくは、水素原子、アルキル基を表す。 R_4 の具体例としては、水素原子;シアノ基:例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、iso-プロピル基、n-ブチル基、iso-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、n-ベンチル基、iso-ベンチル基、2-メチルブチル基、1-メチルブチル基、1-ジメチルプロピル基、1-ジメチルプロピル基、1-ジメチルペンチル基、1-ジメチルペンチル基、1-ジメチルペンチル基、1-ジメチルブチル基、1-ジメチル

phenyl group, naphthyl group, nitro naphthyl group, cyano naphthyl group, hydroxy naphthyl group, methyl naphthyl group, trifluoromethyl naphthyl group or other carbocyclic aryl group; for example pyrrolyl group, thienyl group, furanyl group and oxiny yl group, isoxazoyl basis, oxa diazo yl group, imidazoyl group and benzo oxy yl group, benzo thiazoyl group, benzo imidazoyl group, benzofuranyl group and India yl group or other heterocyclic aryl group; for example methylthio group, ethyl thio group, n-propyl thio group, iso-propyl thio group, n-butyl thio group, iso-butyl thio group, s-butyl thio group, t-butyl thio group, n-pentyl thio group, iso-pentyl thio group, 2- methyl butyl thio group, 1- methyl butyl thio group, neo-pentyl thio group, 1, 2dimethyl propyl thio group and 1, 1- dimethyl propyl thio group or other alkyl thio group; for example phenylthio group, 4- methylphenyl thio group, 2- methoxyphenyl thio group, 4- t-butyl phenylthio group or other aryl thio group; for example allyl oxycarbonyl group and 2- butenoxy carbonyl group or other alkenyl oxycarbonyl group; for example benzyloxycarbonyl group and phenethyl oxycarbonyl group or other aralkyloxy carbonyl group;

[0012] For example methoxycarbonyl methoxycarbonyl group, ethoxy carbonyl methoxycarbonyl group, n-propoxy carbonyl methoxycarbonyl group and isボウロボキシ carbonyl methoxycarbonyl group or other alkoxy carbonyl alkoxy carbonyl group; the for example methyl carbonyl methoxycarbonyl group and ethyl carbonyl methoxycarbonyl group or other alkyl carbonyl alkoxy carbonyl group; for example di (methoxyethyl) amino carbonyl group, di (ethoxymethyl) amino carbonyl group, di (ethoxyethyl) amino carbonyl group and di (propoxyethyl) amino carbonyl group or other di (alkoxy alkyl) amino carbonyl group; the for example vinyl group, propenyl group, 1-butenyl group, isobutenyl group, 1-pentenyl group, 2-pentenyl group, the 2methyl-1- butenyl group, 3- methyl-1- butenyl group, 2methyl-2- butenyl group, 2, 2- di cyano vinyl group, 2cvano-2- methyl carboxyl vinyl group and 2- cvano-2methyl sulfone vinyl group or other alkenyl group can belisted.

[0013] R4 displays hydrogen atom, cyano group, alkyl group, aralkyl group, the carbocyclic aryl group, heterocyclic aryl group or alkenyl group, displays preferably, hydrogen atom and the alkyl group. As embodiment of R4, hydrogen atom; cyano group; for example methyl group, ethyl group, n-propyl group, iso-propyl group, n-butyl group, iso-butyl group, s-butyl group, t-butyl group, n-pentyl group, iso-pentyl group, 2- methyl butyl group, 1- methyl butyl group, neo-pentyl group, 1, 2- dimethyl propyl group, 1, 1- dimethyl propyl group, cyc lo-pentyl group, n-hexyl group, 4-methyl group, 3- methyl pentyl group, 2- methyl pentyl group, 1- methyl pentyl group, 3- dimethyl butyl

ブチル基、1,2-ジメチルブチル基、1,1-ジメチルブチル基、 3-エチルブチル基、2-エチルブチル基、1-エチルブチル基、 1,2,2-トリメチルブチル基、1,1,2-トリメチルブチル基、1 -エチル-2- メチルプロピル基、cyclo-ヘキシル基、n-ヘブ チル基、2-メチルヘキシル基、3-メチルヘキシル基、4-メチ ルヘキシル基、5-メチルヘキシル基、2,4-ジメチルペンチル 基、n-オクチル基、2-エチルヘキシル基、2,5-ジメチルヘキ シル甚、2.5.5-トリメチルペンチル甚、2.4-ジメチルヘキシ ル基、2,2,4-トリメチルペンチル基、n-ノニル基、3,5,5-トリメチルヘキシル基、n-デシル基、4-エチルオクチル基、 4-エチル-4:5- ジメチルヘキシル基、n-ウンデシル基、n-ド デシル甚、1,3,5,7-テトラメチルオクチル基、4-ブチルオク チル基、6,6-ジエチルオクチル基、n-トリデシル基、6-メチ ル-4- ブチルオクチル基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシ ル基、3.5-ジメチルヘプチル基、2.6-ジメチルヘプチル基、 2.4-ジメチルヘブチル甚、2.2.5.5-テトラメチルヘキシル甚 、1-cyclo-ペンチル-2.2- ジメチルプロピル基、1-cyclo-ヘキシル-2,2- ジメチルプロピル基等の直鎮、分岐または環 状のアルキル基:

[0014] 例えば、ペンジル基、ニトロペンジル基、シア ノベンジル基、ヒドロキシベンジル基、メチルベンジル基、 ジメチルベンジル基、トリメチルベンジル基、ジクロロベン ジル基、メトキシペンジル基、エトキシペンジル基、トリフ・ ルオロメチルベンジル基、ナフチルメチル基、ニトロナフチ ルメチル基、シアノナフチルメチル基、ヒドロキシナフチル メチル基、メチルナフチルメチル基、トリフルオロメチルナ フチルメチル基等のアラルキル基: 例えば、フェニル基、ニト ロフェニル甚、シアノフェニル基、ヒドロキシフェニル基、 メチルフェニル基、ジメチルフェニル基、トリメチルフェニ ル基、ジクロロフェニル基、メトキシフェニル基、エトキシ フェニル基、トリフルオロメチルフェニル基、N.N-ジメチル アミノフェニル基、ナフチル基、ニトロナフチル基、シアノ ナフチル基、ヒドロキシナフチル基、メチルナフチル基、ト リフルオロメチルナフチル基等の炭素環式アリール基:ピロリ ル基、チエニル基、フラニル基、オキサゾイル基、イソオキ サゾイル基、オキサジアゾイル基、イミダゾイル基、ペンゾ オキサゾイル基、ペンゾチアゾイル基、ペンソイミダゾイル 基、ベンゾフラニル基、インドイル基等の複素環式アリール 基:例えば、ビニル基、プロペニル基、1-プテニル基、iso -ブテニル基、1-ペンテニル基、2-ペンテニル基、2-メチル -1- ブテニル基、3-メチル-1- ブテニル基、2-メチル-2-ブテニル基、2,2-ジシアノビニル基、2-シアノ-2- メチルカ ルポキシルビニル基、2-シアノ-2- メチルスルホンビニル基 等のアルケニル甚を挙げることができる。

【0015】R₁₀およびR₁はフッ素原子、アルキル基、アラルキル基、炭素環式アリール基、複素環式アリール基、またはアルコキシ基を表し、好ましくは、フッ素原子を表す。

group , 2, 3- dimethylbutyl group , 1, 3- dimethylbutyl group , 2, 2-dimethylbutyl group, 1, 2-dimethylbutyl group, 1, 1dimethylbutyl group, 3- ethyl butyl group, 2, ethyl butyl group, 1-ethyl butyl group, 1,2, 2-trimethyl butyl group, 1,1, 2- trimethyl butyl group, alkyl group of 1- ethyl-2- methyl propyl group, cyc lo-hexyl group, n-heptyl group, 2methyl hexyl group, 3- methyl hexyl group, 4- methyl hexyl group , 5- methyl hexyl group , 2, 4- dimethyl pentyl group , noctyl group, 2- ethylhexyl group, 2,5- dimethyl hexyl group, 2,5,5- trimethyl pentyl group, 2, 4- dimethyl hexyl group, 2,2, 4- trimethyl pentyl group, n-nonyl group, 3,5,5- trimethyl hexyl group, n-decyl group, 4-ethyl octyl group, 4-ethyl-4, 5- dimethyl hexyl group, n- undecyl group, n- dodecyl group, 1,3,5,7- tetramethyl octyl group, 4- butyl octyl group, 6,6diethyl octyl group, n-tridecyl group, 6-methyl-4- butyl octyl group, n-tetradecyl group, n-pentadecyl group, 3,5dimethyl heptyl group, 2,6-dimethyl heptyl group, 2,4dimethyl heptyl group, 2,2,5,5- tetramethyl hexyl group, 1cyc lo-pentyl-2, 2- dimethyl propyl group, 1-cyc lo-hexyl-2, 2- dimethyl propyl group or other straight chain and branched or cyclic;

[0014] For example benzyl group, nitrobenzyl group, cyano benzyl group, hydroxy benzyl group, methylbenzyl group, dimethyl benzyl group, trimethyl benzyl group, dichloro benzyl group , $\,$ methoxy benzyl group , $\,$ ethoxy benzyl group , trifluoromethyl benzyl group, naphthyl methyl group, nitro naphthyl methyl group, cyano naphthyl methyl group, hydroxy naphthyl methyl group, methyl naphthyl methyl group, trifluoromethyl naphthyl methyl group or other aralkyl group; for example phenyl group, nitrophenyl group, cyanophenyl group, hydroxyphenyl group, methyl phenyl group, dimethylphenyl group, trimethyl phenyl group, dichlorophenyl group, methoxyphenyl group, ethoxy phenyl group, trifluoromethyl phenyl group, N, N-dimethylamino phenyl group, naphthyl group, nitro naphthyl group, cyano naphthyl group, hydroxy naphthyl group, methyl naphthyl group, trifluoromethyl naphthyl group or other carbocyclic aryl group; pyrrolyl group, thienyl group, furanyl group and oxa y yl group, isoxazoyl basis, oxa diazo yl group, imidazoyl group and benzo ox $\mathcal Y$ yl group, benzo thiazoyl group, benzo imidazoyl group, benzofuranyl group and India yl group or other heterocyclic aryl group; for example vinyl group, propenyl group, 1-butenyl group, iso-butenyl group, 1- pentenyl group, 2- pentenyl group, the 2- methyl-1butenyl group, 3- methyl-1- butenyl group, 2- methyl-2butenyl group, 2, 2- di cyano vinyl group, 2- cyano-2methyl carboxyl vinyl group and 2- cyano-2- methyl sulfone vinyl group or other alkenyl group can belisted.

[0015] R10 and R11 displays fluorine atom, alkyl group, aral kyl group, carbocyclic aryl group, the heterocyclic aryl group or alkoxy group, displays preferably and fluorine atom. As

R₁₀およびR₁₁の具体例としては、フッ素原子:例えば、メ チル基、エチル基、n-プロピル基、iso-プロピル基、n-ブチ ル基、iso-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、n-ペンチ ル基、iso-ペンチル基、2-メチルブチル基、1-メチルブチル 基、neo-ペンチル基、1,2-ジメチルプロピル基、1,1-ジメチ ルプロピル基、cyclo-ペンチル基、n-ヘキシル基、4-メチル ペンチル基、3-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、1 -メチルペンチル基、3.3-ジメチルブチル基、2.3-ジメチル ブチル基、1.3-ジメチルブチル基、2.2-ジメチルブチル基、 1,2-ジメチルブチル基、1,1-ジメチルブチル基、3-エチルブ チル基、2-エチルプチル基、1-エチルプチル基、1.2.2-トリ メチルブチル基、1,1,2-トリメチルブチル基、1-エチル-2-メチルプロピル基、cyclo-ヘキシル基、n-ヘプチル基、2-メチルヘキシル基、3-メチルヘキシル基、4-メチルヘキシル 基、5-メチルヘキシル基、2.4-ジメチルペンチル基、N-オク チル基、2-エチルヘキシル基、2.5-ジメチルヘキシル基、2 .5.5-トリメチルペンチル基、2.4-ジメチルヘキシル基、2. 2.4-トリメチルペンチル基、n-ノニル基、3,5,5-トリメチル ヘキシル基、n-デシル基、4-エチルオクチル基、4-エチル-4.5- ジメチルヘキシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基 、1,3,5,7-テトラメチルオクチル基、4-プチルオクチル基、 6.6-ジェチルオクチル基、n-トリデシル基、6-メチル-4- ブ チルオクチル基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシル基、3 .5-ジメチルヘプチル基、2,6-ジメチルヘプチル基、2,4-ジ メチルヘプチル基、2,2,5,5-テトラメチルヘキシル基、1-c yclo-ペンチル-2.2- ジメチルプロピル基、1-cyclo-ヘキシ ル-2.2- ジメチルプロビル基等の直鎖、分岐または環状のア ルキル基:

【0016】例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキ シ基、iso-プロポキシ基、n-ブトキシ基、iso-ブトキシ基、 sec-ブトキシ基、t-ブトキシ基。n-ペントキシ基、iso-ペン トキシ基、neo-ペントキシ基、n-ヘキシルオキシ基、n ード デシルオキシ基等のアルコキシ基: 例えば、ベンジル基、ニ トロベンジル基、シアノベンジル基、ヒドロキシベンジル基 、メチルベンジル基、ジメチルベンジル基、トリメチルベン ジル基、ジクロロベンジル基、メトキシベンジル基、エトキ シベンジル基、トリフルオロメチルベンジル基、ナフチルメ チル基、ニトロナフチルメチル基、シアノナフチルメチル基 、ヒドロキシナフチルメチル基、メチルナフチルメチル基、 トリフルオロメチルナフチルメチル基等のアラルキル基:例え ば、フェニル基、ニトロフェニル基、シアノフェニル基、ヒ ドロキシフェニル基、メチルフェニル基、ジメチルフェニル 基、トリメチルフェニル基、ジクロロフェニル基、メトキシ フェニル基、エトキシフェニル基、トリフルオロメチルフェ ニル基、N.N-ジメチルアミノフェニル基、ナフチル基、ニト ロナフチル基、シアノナフチル基、ヒドロキシナフチル基、 メチルナフチル基、トリフルオロメチルナフチル基等の炭素 環式アリール基:ピロリル基、チエニル基、フラニル基、オキ サゾイル基、イソオキサゾイル基、オキサジアゾイル基、イ

embodiment of R10 and R11, fluorine atom; for example methyl group, ethyl group, n-propyl group, iso-propyl group, n-butyl group, iso-butyl group, s-butyl group, tbutyl group, n-pentyl group, iso-pentyl group, 2-methyl butyl group, 1- methyl butyl group, neo-pentyl group, 1, 2dimethyl propyl group, I, I-dimethyl propyl group, cyc lopentyl group, n-hexyl group, 4-methyl pentyl group, 3methyl pentyl group, 2- methyl pentyl group, 1- methyl pentyl group, 3, 3-dimethylbutyl group, 2, 3-dimethylbutyl group, 1, 3-dimethylbutyl group, 2, 2-dimethylbutyl group, 1, 2- dimethylbutyl group, 1, 1- dimethylbutyl group, 3- ethyl butyl group, 2-ethyl butyl group, 1-ethyl butyl group, 1,2,2trimethyl butyl group, 1,1,2-trimethyl butyl group, alkyl group of 1-ethyl-2- methyl propyl group, cyc lo-hexyl group, n-heptyl group, 2-methyl hexyl group, 3-methyl hexyl group, 4- methyl hexyl group, 5- methyl hexyl group, 2, 4- dimethyl pentyl group, n- octyl group, 2- ethylhexyl group, 2.5-dimethyl hexyl group, 2.5.5- trimethyl pentyl group, 2, 4- dimethyl hexyl group, 2,2, 4- trimethyl pentyl group, n-nonyl group, 3,5,5- trimethyl hexyl group, ndecyl group, 4- ethyl octyl group, 4- ethyl-4,5- dimethyl hexyl group, n-undecyl group, n-dodecyl group, 1,3,5,7tetramethyl octyl group, 4- butyl octyl group, 6,6- diethyl octyl group, n-tridecyl group, 6- methyl-4- butyl octyl group, n-tetradecyl group, n-pentadecyl group, 3,5dimethyl heptyl group, 2,6-dimethyl heptyl group, 2,4dimethyl heptyl group, 2,2,5,5- tetramethyl hexyl group, 1cvc lo-pentyl-2, 2- dimethyl propyl group, 1-cyc lo-hexyl-2, 2- dimethyl propyl group or other straight chain and branched or cyclic;

[0016] For example methoxy group, ethoxy group, n-propo xy group, iso-propoxy group, n-butoxy group, iso-butoxy group, s-butoxy group, t-butoxy group, n-pentoxy group, iso-pentoxy group ,neo-pentoxy group , n-hexyloxy group and n - dodecyl oxy group or other alkoxy group; for example benzyl group, nitrobenzyl group, cyano benzyl group, hydroxy benzyl group, methylbenzyl group, dimethyl benzyl group, trimethyl benzyl group, dichloro benzyl group, methoxy benzyl group, ethoxy benzyl group, trifluoromethyl benzyl group, naphthyl methyl group, nitro naphthyl methyl group, cyano naphthyl methyl group, hydroxy naphthyl methyl group, methyl naphthyl methyl group, trifluoromethyl naphthyl methyl group or other aralkyl group; for example phenyl group, nitrophenyl group, cyanophenyl group, the hydroxyphenyl group, methyl phenyl group, dimethylphenyl group, trimethyl phenyl group, dichlorophenyl group, methoxyphenyl group, the ethoxy phenyl group, trifluoromethyl phenyl group, N. Ndimethylamino phenyl group, naphthyl group, nitro naphthyl group, cyano naphthyl group, the hydroxy naphthyl group, methyl naphthyl group, trifluoromethyl

ミダゾイル基、ベンゾオキサゾイル基、ベンゾチアゾイル基 、ベンゾイミダゾイル基、ベンゾフラニル基、インドイル基 等の複素環式アリール基を挙げることができる。

【〇〇17】本発明の一般式(1)で示されるペンソピロメテン化合物は、其自体公知の方法に従って製造することができる。例えば、Journal of Chemical Society, Chemical Communication, 1994, 1129-1130に記載の方法に従い製造される一般式(2)(化3)で示される化合物と、三フッ化ホウ素類とを反応させて、一般式(3)(化3)で示される化合物を製造した後、フッ素原子を置換して一般式(1)で示されるペンソピロメテン化合物を合成する。

[0018]

[化3] |

(上式中、 $R_1 \sim R_9$ は前記に同じ。)本発明に用いられる一般式 (1) で示されるペンソピロメテン化合物の具体例としては、例えば、第1表 (表1 \sim 3) に示す化合物を挙げることができるが、本発明はこれらの例示化合物に限定されるものではない。

[0019]

naphthyl group or other carbocyclic aryl group; pyrrolyl group, thienyl group, furanyl group and ox yl group, isoxazoyl basis, oxa diazo yl group, imidazoyl group and benzo o yl group, the benzo thiazoyl group, benzo imidazoyl group, benzofuranyl group and India yl group or other heterocyclic aryl group can be listed.

[0017] Following to itself known method, it can produce ben zo pyro methene compound which is shownwith General Formula (1) of this invention. Reacting with compound and boron trifluoride which are shown with General Formula (2) (Chemical formula 3) which is produced in accordance with method which is stated in the for example Journal of the Chemical Society, Chemical Communications (1359-7345, JCCCAT), 1994, 1129-1130, after producing compound which is shown with general formula (3) (Chemical formula 3), substituting fluorine atom, it synthesizes benzo pyro methene compound which is shown with the General Formula (1).

[0018]

[Chemical Formula 3]

Compound which is shown in for example Table 1 (Table 1 to 3) as embodiment of benzo pyro methene compound whichis shown with General Formula (1) which is used for (In above equation, as for R1 to R9 same to description above.) this invention, can be listed, but this invention is not something which is limited in these example compound.

[0019]

【表 1】|

[Table 1]

化合物	Œ	ď	ď	ď	æ	ھے	až.	200	æ	ag ag	1
<u>:</u>	ફુ	ς, Ή	ธ์	I	I	Ŧ	∓	=	Ç		-
1.2	ર્સ	r	ર્કે	I	I	I	Ŧ	I	Ŷ	. _. .	. ц
1 .3	ફ	I	કૈં	r	I	I	I	r	₩ 000 P	щ	. LL.
1-4	ธ์	(CH ₂) ₂ CH(CH ₃) ₂ CH ₃	3)2 Pf3	I	I	I	I	I	фо С	u	ц
1.5	I	Ť Č	式 ど	I	I	r	I	.	ž,		. <u>u</u>
9-	ર્ક	ያቸ ያ	ર્કેં	I	I	t-Bu	t-Bu	I	P	. "	. ` щ
1.7	<i>ಕੰ</i>	ቸ ሪ	چ پ	I	I	I		I	ชื	ш	L
1-8	P	I	Ŷ	x	I	I	I	Ξ	Ι	. ц.	. L
1-8	<u>ਵ</u> ੰ	t-Bu	ર્દ	I	I	x	I	I	Š Š	L,	щ
1-10	Q.	I	र्हें	r	I	r	. I	I	₹	Ŀ	Ľ
1.11	ਝੌ		P	x	r	I	I	I	Me T-Bu	ıL	
1-12	ธ์	ភ្ជុំ	Ct-Bu	ਝੰ	I	I	I	I	Ç	u.	i.
1.13	I,	ર્સ	I	I	x	I	I	I	P	īT	L
1-14	x	t-Bu	I	I	ર્ફ	కో	ર્સું	ಕೆ	Ŷ	u.	· LL

[0020]

[0020]

化合物	Œ	æ	æ	ď	æ	æ	æ	æ	æ	P.	œ.
1-15	\$45500	n-C ₈ H ₁₃	∞25Hg	Ξ	I	Ϋ́	-SQ-1-Bu	I	ጟ	L.	Ľ.
1-16	రో	8 4 8	P	8	<u>8</u>	ફુ	8	ğ	I	9	IL.
1-17	£	۵	₹ S	I	· I	I	Ø	I	Ÿ	ո-C ₈ Ալյ	P.C. H.1
1-18	Me Me	ı I	I	8	I	r	I	I	O) 4550	142)2CH(CH3)	∞26246 (CH2)24H(CH3)2 (CH2)24H(CH3)
1.19	8 ¥	ೲೲೲೲ	ž ř	I	I	I	I	I	Ó	UE.	u.
1-20	Å,	ર્સ	τς C	I	0€2H ₅	8C2Hg	8 7.	002H	б	L	L.
1-21	Ç	ર્સ	ર્ક	ર્કેં	I	I	· I	r	¥28	L	LL
1-22	H -S·t·Bu	٥	۵	I	I	t-Bu	t-Bu	ı	P	Ç	L .
1-23	కో	n-C4H	I	9	I	I	I	I	£	₹ 8	90 F
1-24	ર્દ	,0~0.t-Bu	· ફ્ર	Ŷ	x	I	I	I	∞,α-⊶	٠ 	iL.
1.25	Z ~0	8	I	8	I	t-Bu	t-Bu	I	82.0	ш	Ŷ
1.26	ੂੰ ਰੰ	CONH(CH ₃) ₂	Ψ. ~	Me Me	F F	Q	Ŷ	I	weak way incelling	s n-C ₆ H ₁₁	n-CeH11
1-27	82,0 H _k	NHCOC2HS	÷ g	ŽI.	ર્કે	ર્દે	ઈ	ર્દ	Ŷ	ŭ.	(CH ₂) ₂ CH(CH ₃)
1.28	ಕ	COHN	ક	I	I	I	I	I	Œ Ç	L	u.

[0021]

[0021]

•							٠.			
	ا م	- L	n-C ₈ H ₁₁	Z %	⊕ ત્ં	P	 u.	ш	u,	
	P.S.	8	_	Z.O		Ŷ	<u>u</u>	. L	u.	
	æ	♦	-SQ-t-Bu	t-Bu	P	Į Į	G G	9	Me t-Bu	Me
	æ	Ŧ	I	۵	I	r	I	r	8	
	æ	I	I	۵	I	I	I	8	8	
	æ	I	I	٥	I	r	I	Ŗ	ફુ	
	عه	I	I	٥	I	I	x	I	ğ	
		Me N	ΞΞ	I	I	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ઠ	I	I	
	С	ຮຶ້	ર્કે	ਝੌ	ਝੌ	ર્ફ	ર્કે	ਝੌ	I	
<u>,</u>	æ	00	-S-t-Bu	ğ	₩	۳, ۲,	CON(CH2OCH3)2	Q %	CH=CH ₂	
(eE	ธื	3	రో	ਝੌ	Q ₂ 00H ₃	7. 7.	GH200H3	ર્કે	
Ř	完全	1-29	1.30	1.31	1-32	1-33	1-34	1-35	1-36	

【0022】有機電界発光素子は、通常、一対の電極間に、 少なくとも1種の発光成分を含有する発光層を、少なくとも 一層挟持してなるものである。発光層に使用する化合物の正 孔注入および正孔輸送、電子注入および電子輸送の各機能レ ベルを考慮し、所望に応じて、正孔注入輸送成分を含有する 正孔注入輸送層または/および電子注入輸送成分を含有する 電子注入輸送層を設けることもできる。例えば、発光層に使

[0022] Organic electroluminescent element, usually, between pair of electrodes, at least one layer clamping doing theluminescent layer which contains light emission component of at least 1 kind, is something which becomes. It considers each functional level of positive hole injection and positive hole transport, the electron injection and electron transport of compound which is used for luminescent layer, it is possible also

用する化合物の正孔注入機能、正孔翰送機能または/および電子注入機能、電子翰送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入翰送層または/および電子注入翰送層を兼ねた型の素子の構成とすることができる。勿論、場合によっては、正孔注入翰送層および電子注入翰送層の両方の層を設けない型の素子(一層型の素子)の構成とすることもできる。また、正孔注入翰送層、電子注入翰送層および発光層のそれぞれの層は、一層構造であっても多層構造であってもよく、正孔注入翰送層および電子注入翰送層は、それぞれの層において、注入機能を有する層と翰送機能を有する層を別々に設けて構成することもできる。|

【0023】本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に、前記一般式(1)で表される化合物を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子である。本発明の有機電界発光素子において、一般式(1)で表される化合物は、正孔注入輸送成分、発光成分または電子注入輸送成分に用いることが好ましく、発光成分または電子注入輸送成分に用いることがより好ましい。本発明の有機電界発光素子においては、一般式(1)で表される化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0024】本発明の有機電界発光素子の構成としては、特に限定するものではなく、例えば、(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図1)、(B)陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰極型素子(図2)、(C)陽極/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図3)、(D)陽極/発光層/陰極型素子(図4)などを挙げることができる。さらには、発光層を電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/に表光層/電子注入輸送層/に表光層/電子注入輸送層/に表光度分を一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子は勿論であるが、さらには、例えば、(F)正孔注入輸送成分、発光成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図6)、(G)正孔注入輸送成分および発光成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図6)、(G)正孔注入輸送成分および発光成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図6)、(G)正孔注入輸送成分および発光成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図6)、(G)正孔注入輸送成分および発光成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた一層形態で一対の電極間に挟持させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図6)、(G)正孔注入輸送成分および発光成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図6)に対している。

to provide electron-implanted transport layer which contains positive hole injection transport layer and/or electron injection transportcomponent which contains positive hole injection transport component according to desire. When positive hole injection function and positive hole transport functional and/or electron injection function of compoundwhich is used for for example luminescent layer, electron transport function is satisfactory, it it canconstitute of element of type where luminescent layer combines thepositive hole injection transport layer and/or electron-implanted transport layer. Of course, it is possible also to constitute of element (element of single layer type) of thetype which does not provide layer of both of positive hole injection transport layer or theelectron-implanted transport layer depending upon in case. In addition, respective layer of positive hole injection transport layer, electronimplanted transport layer and theluminescent layer, even when being a construction more, may be multilayer construction, the positive hole injection transport layer and electron-implanted transport layer can also constitute providing layer whichpossesses injection function in respective layer, and layer whichpossesses transport function separately.

[0023] Organic electroluminescent element of this invention, b. etween pair of electrodes, at least one layer clamping doing layerwhich at least 1 kind contains, compound which is displayed with theaforementioned General Formula (1), is organic electroluminescent element which becomes. In organic electroluminescent element of this invention, as for compound which is displayed withthe General Formula (1), positive hole injection transport component, it is desirable to use for the light emission component or electron injection transport component or electron injection transport component. Regarding organic electroluminescent element of this invention, it is possible to use compoundwhich is displayed with General Formula (1), with alone, or multiple tojointly use is possible.

[0024] As constitution of organic electroluminescent element of this invention, it is not something whichespecially is limited, for example (A) anode / positive hole injection transport layer / luminescent layer / electron-implanted transport layer / cathode type element (Figure 1), (B) anode / positive hole injection transport layer / luminescent layer / cathode type element (Figure 2),the (C) anode / luminescent layer / electron-implanted transport layer / cathode type element (Figure 3) and (D) anode / luminescent layer / cathode type element (Figure 4) etc can be listed. Furthermore, it is possible also to make (E) anode / positive hole injection transport layer / electron-implanted transport layer / luminescent layer / electron-implanted transport layer / cathode type element (Figure 5) which is a element of type which inserts luminescent layer with electron-implanted transport layer. As element configuration

た型の素子(図7)、または(H)発光成分および電子注入 輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた 型の素子(図8)がある。

【0025】本発明の有機電界発光素子は、これらの素子構成に限るものではなく、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層を複数層設けたりすることができる。また、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層と発光層との間に、正孔注入輸送層と発光成分の混合層または/および発光層と電子注入輸送層との間に、発光成分と電子注入輸送成分の混合層を設けることもできる。より好ましい有機電界発光素子の構成は、(A)型素子、(B)型素子、(C)型素子、(F)型素子、(G)型素子または(H)型素子であり、さらに好ましくは、(A)型素子、(B)型素子、(C)型素子、(F)型素子または(H)型素子である。

【0026】本発明の有機電界発光素子としては、例えば、(図1)に示す(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子について説明する。(図1)において、1は基板、2は陽極、3は正孔注入輸送層、4は発光層、5は電子注入輸送層、6は陰極、7は電源を示す。

【0027】本発明の有機電界発光素子は、基板1に支持されていることが好ましく、基板としては、特に限定するものではないが、透明ないし半透明であることが好ましく、例えば、ガラス板、透明プラスチックシート(例えば、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリスルフォン、ポリメチルメタアクリレート、ポリプロピレン、ポリエチレンなどのシート)、半透明プラスチックシート、石英、透明セラミックス、あるいは、これらを組み合わせた複合シートからなるものを挙げることができる。さらに、基板に、例えば、カラーフィルター膜、色変換膜、誘電体反射膜を組み合わせて、発光色

of (D) type, light emission component more with shape element of type which clamping isdone of course is between pair of electrodes but, Furthermore, for example (F) positive hole injection transport component, element (Figure 6) of type which with shape which mixes light emission component and the electron injection transport component clamping is done more between pair of electrodes, with (G) positive hole injection transport component and with element (Figure 7), or (H) light emission component of type which shape which mixes light emission component clamping is donemore between pair of electrodes and there is a element (Figure 8) of type which theshape which mixes electron injection transport component clamping is done morebetween pair of electrodes.

[0025] Organic electroluminescent element of this invention is not something which is limited to theseelement configuration, positive hole injection transport layer, luminescent layer and electron-implanted transport layer multiple layers can be provided in the element of respective type. In addition, with positive hole injection transport layer and luminescent layer, positive hole injection transport componentand with of mixed layer and/or luminescent layer and electron-implanted transport layer of light emission component, it is possible also n element of respective type, to provide mixed layer of light emission componentand electron injection transport component. Constitution of a more desirable organic electroluminescent element, (A) type element, (B) typeelement, (C) type element, (E) type element, (F) type element, is the(G) type element or (H) type element, furthermore preferably and (A)type element, (B) type element, (C) type element, is (F) type elementor (H) type element.

[0026] As organic electroluminescent element of this invention, you explain concerning (A) anode / positive hole injection transport layer / luminescent layer / electron-implanted transport layer / cathode typeelement which is shown in for example (Figure 1). In (Figure 1), as for 1 as for substrate and 2 as for theanode and 3 as for positive hole injection transport layer and 4 as for luminescent layer and 5 as for electron-implanted transport layer and 6 as for cathode and the7 power supply is shown.

[0027] It is not something where as for organic electroluminesc ent element of this invention, it isdesirable, to be supported in substrate 1, especially limits as the substrate. It is desirable, for example glass sheet and transparent plastic sheet (for example polyester, polycarbonate, polysulfone, polymethyl methacrylate, polypropylene and polyethylene or other sheet), semitransparent plastic sheet, quartz andthe transparent ceramic, or, to be a transparent or semitransparent, can list those which consist of thecomposite sheet which combines these. Furthermore, to substrate, is possible also fact

をコントロールすることもできる。

【0028】陽極2としては、比較的仕事関数の大きい金属 、合金または電気電導性化合物を電極物質として使用するこ とが好ましい。陽極に使用する電極物質としては、例えば、 金、白金、銀、銅、コパルト、ニッケル、パラジウム、パナ ジウム、タングステン、酸化錫、酸化亜鉛、ITO(インジ ウム・ティン・オキサイド)、ポリチオフェン、ポリピロー ルなどを挙げることができる。これらの電極物質は、単独で、 使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。陽極は、こ れらの電極物質を、例えば、蒸着法、スパッタリング法等の 方法により、基板の上に形成することができる。また、陽極 は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよ い。陽極のシート電気抵抗は、好ましくは、数百Ω/口以下 、より好ましくは、5~50Ω/口程度に設定する。陽極の 厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般に、5~ 1000nm程度、より好ましくは、10~500nm程度・ に設定する。

【0029】正孔注入翰送層3は、陽極からの正孔(ホール)の注入を容易にする機能、および注入された正孔を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。正孔注入輸送層は、本発明に係る一般式(1)で表される化合物およびグランには他の正孔注入輸送機能を有する化合物(人)、フターン誘導体、トリアリールメタン誘導体、トリアリールアミン誘導体、オキサゾール誘導体、ヒドラゾン誘導体、ポリンテンと誘導体、ポリンテンと誘導体、ポリンテントができる。ボリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリテオフェンおよびその誘導体、ポリテオフェンおよびその誘導体、ポリテオフェンおよびその誘導体、ポリーNービニルカルバゾール誘導体など)を少なくとも1種用いて形成することができる。尚、正孔、輸送機能を有する化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0030】本発明において用いる他の正孔注入輸送機能を有する化合物としては、トリアリールアミン誘導体(例えば、4,4'ーピス【NーフェニルーNー(4"ーメチルフェニル)アミノ】ピフェニル、4,4'ーピス【NーフェニルーNー(3"ーメトキシフェニル)アミノ】ピフェニル、4,4'ーピス【NーフェニルーNー(3"ーメトキシフェニルー)アミノ】ピフェニル、3,3'ージメチルー4,4'ーピス【NーフェニルーNー(3"ーメチルフェニル)アミノ】ピフェニル、1,1ーピス【4'ー【Nージ(4"ーメチルフェニル)アミノ】フェニル〕シクロへキサン、9,10ーピス【Nー(4'ーメチルフェニル

that emission color iscontrolled combining for example color filter film, color conversion film and dielectric reflective film.

[0028] As anode 2, as electrode substance, it is desirable to use metal, the alloy or electrical conductivity compound where work function is large relatively. for example gold, platinum, silver, copper, cobalt, nickel, the palladium, vanadium, tungsten, tin oxide, zinc oxide, TPO (indium* tin* oxide), the polythiophene and polypyrrole etc can be listed as electrode substance which is used forthe anode. It is possible to use these electrode substance, with alone, or plural tojointly use is possible. It can form anode, on substrate these electrode substance, with for example vapor deposition method andthe sputtering method or other method. In addition, anode may be structure more, or to be multilayer structure ispossible. It sets sheet electrical resistance of anode, to preferably, several hundred /square or below, more preferably andthe 5 to 50

/square extent. thickness of anode, it depends on also material of electrode substancewhich is used, but generally, it sets to 5 to 1000 nm extent, more preferably and the 10 to 500 nm extent.

[0029] Positive hole injection transport layer 3 makes fill of po sitive hole (hole) from anode easy is layerwhich contains compound which possesses function which transportsthe positive hole which functioned, and was filled and. at least 1 kind using compound (Such as for example phthalocyanine derivative, triaryl methane derivative, triaryl amine derivative, oxazole derivative, hydrazone derivative, stilbene derivative, pyrazoline derivative, poly silane derivative, polyphenylene vinyleneand its derivative, polythiophene and its derivative and poly N - vinyl carbazole derivative) which possesses compound and/or other positive hole injection transport function which is displayed with General Formula (1) which relates to this invention it canform positive hole injection transport layer. Furthermore it is possible to use compound which possesses the positive hole injection transport function, with alone, or plural to jointly use is possible.

[0030] Regarding to this invention, triaryl amine derivative (f or example 4, 4' - bis (N - phenyl - N - (4" - methylphenyl) amino) biphenyl , 4, 4' - bis (N - phenyl - N - (3" - methylphenyl) amino) biphenyl , 4, 4' - bis (N - phenyl - N - (3" - methoxyphenyl) amino) biphenyl , 4, 4' - bis (N - phenyl - N - (1" - naphthyl) amino) biphenyl , 3, 3'-di methyl - 4, 4' - bis (N - phenyl - N - (3" - methylphenyl) amino) biphenyl , 1, 1 - bis (4' - [N,N-di (4" - methylphenyl) amino] phenyl) cyclohexane , 9,10 - bis (N - (4' - methylphenyl) - N - (4" - n-butyl phenyl) amino) phenanthrene , 3,8 - bis (N,N-di phenylamino) - 6 - phenyl phenanthridine and 4 - methyl - N,N - bis (4",4" - bis [N',

) -N-(4"-n-ブチルフェニル) アミノ) フェナント レン、3、8-ビス(N, N-ジフェニルアミノ) -6-フ ェニルフェナントリジン、4ーメチルーN、Nービス [4" . 4´´` ーピス[N`, N`ージ (4ーメチルフェニル) ア ミノ] ピフェニルー4ーイル) アニリン、N, N' ーピス (4-(ジフェニルアミノ) フェニル) -N, N' -ジフェニ ルー1, 3ージアミノベンゼン、N, N' ーピス [4ー (ジ フェニルアミノ) フェニル】 - N、 N' - ジフェニル - 1. 4ージアミノベンゼン、5, 5"ービス [4ー(ビス[4ー メチルフェニル] アミノ) フェニル] -2, 2':5', 2 "ーターチオフェン、1、3、5ートリス(ジフェニルアミ) ノ) ベンゼン、4、4'、4" ートリス (Nーカルパソリル) トリフェニルアミン、4, 4', 4"ートリス (Nー (3 ··· ーメチルフェニル)-N-フェニルアミノ}トリフェニ ルアミン、1、3、5-トリス [N-(4'-ジフェニルア ミノフェニル) フェニルアミノ) ベンゼンなど) 、ポリチオ フェンおよびその誘導体、ポリーN-ピニルカルパゾール誘 導体がより好ましい。本発明において、一般式 (1) で表さ れる化合物と他の正孔注入輸送機能を有する化合物を併用す る場合、正孔注入輸送層中に占める一般式 (1) で表される 化合物の割合は、好ましくは、0.1~4.0重量%程度に調 製する。1

【0031】発光層4は、正孔および電子の注入機能、それ らの輸送機能、正孔と電子の再結合により励起子を生成させ る機能を有する化合物を含有する層である。発光層は、一般 式(1)で表される化合物および/または他の発光機能を有 する蛍光性化合物(例えば、アクリドン誘導体、キナクリド ン誘導体、多環芳香族化合物(例えば、ルブレン、アントラ セン、テトラセン、ピレン、ペリレン、クリセン、デカシク レン、コロネン、テトラフェニルシクロペンタジエン、ペン タフェニルシクロペンタジエン、9、10ージフェニルアン トラセン、9、10-ビス (フェニルエチニル) アントラセ ン、1、4-ビス(9'-エチニルアントラセニル)ベンゼ ン、4、4 ーピス(9"ーエチニルアントラセニル)ピフ ェニル〕、トリアリールアミン誘導体〔例えば、正孔注入輸 送機能を有する化合物として前述した化合物を挙げることが できる〕、有機金属錯体〔例えば、トリス(8-キノリノラ ート)アルミニウム、ピス (10-ベンゾ[h] キノリノラー ト) ベリリウム、2-(2'-ヒドロキシフェニル) ベンゾ オキサゾールの亜鉛塩、2- (2'-ヒドロキシフェニル) ペンゾチアゾールの亜鉛塩、4ーヒドロキシアクリジンの亜 鉛塩】、スチルペン誘導体〔例えば、1、1、4、4ーテト ラフェニルー1. 3ープタジエン、4.4'ーピス(2.2 ージフェニルピニル)ピフェニル】、クマリン誘導体〔例え ば、クマリン1、クマリン6、クマリン7、クマリン30、 クマリン106、クマリン138、クマリン151、クマリ ン152、クマリン153、クマリン307、クマリン31 1、クマリン314、クマリン334、クマリン338、ク マリン343、クマリン500)、ピラン誘導体(例えば、 DCM1、DCM2]、オキサゾン誘導体〔例えば、ナイル レッド〕、ベンゾチアゾール誘導体、ベンゾオキサゾール誘 導体、ベンゾイミダゾール誘導体、ピラジン誘導体、ケイ皮

N'-di (4 - methylphenyl) amino] biphenyl - 4-yl) aniline, N, N'-bis (4 - (diphenylamino) phenyl) - N, N'-di phenyl - 1,3di amino benzene, N, N' - bis (4 - (diphenylamino) phenyl) -N, N'-di phenyl - 1,4-di amino benzene , 5,5" - bis (4 - (bis [4 methylphenyl] amino) phenyl) - 2, 2': 5', 2" - terthiophene, 1,3,5 - tris (diphenylamino) benzene, 4, 4', 4" - tris (N carbozolyl) triphenyl amine and4, 4', 4"-tris (N-(3" methylphenyl) - N - phenylamino) triphenyl amine , such as 1, 3,5 - tris (N - (4'-di phenylamino phenyl) phenylamino) benzene), polythiophene and its derivative and the poly Nvinyl carbazole derivative are more desirable as compound which possesses other positive hole injection transport functionwhich it uses. Regarding to this invention, when it jointly uses compound which possesses the compound and other positive hole injection transport function which are displayed with General Formula (1), asfor ratio of compound which is displayed with General Formula (1) which itoccupies in positive hole injection transport layer, it manufactures in preferably and 0.1 to 40 weight % extent.

[0031] Luminescent layer 4 is layer which contains compound which possesses thefunction which forms exciton injection function of positive hole and electron, those transport function, with recombination of positive hole and electron. at least 1 kind using fluorescence compound (for example acridone derivative, quinacridone derivative, polycyclic aromatic compound (for example rubrene, anthracene, tetracene, pyrene, perylene, chrysene, decacyclene, coronene, tetra phenyl cyclopentadiene, pentaphenyl cyclopentadiene, 9,10-di phenyl anthracene, 9,10 - bis (phenyl ethinyl) anthracene, 1,4 - bis (9' - ethinyl anthracenyl) benzene . 4, 4' - bis (9" - ethinyl anthracenyl) biphenyl), triaryl amine derivative (compound which you mention earlier as compound which possesses for example positive hole injection transport function can be listed), organometallic complex (for example tris (8 - quinolinolato) aluminum, bis (10 - benzo [h] quinolinolato) beryllium, zinc salt of 2 - (2'hvdroxvphenvl) benzoxazole, zinc salt of 2 - (2' hydroxyphenyl) benzothiazole, zinc salt of 4 - hydroxy acridine), stilbene derivative (for example 1,1,4,4 - tetra phenyl - 1,3 - butadiene, 4, 4' - bis (2,2-di-phenyl vinyl) biphenyl), coumarin derivative (for example coumarin 1, coumarin 6, coumarin 7, coumarin 30, coumarin 106, coumarin 138, coumarin 151, coumarin 152, coumarin 153, coumarin 307, coumarin 31 1, coumarin 31 4, coumarin 334, coumarin 338, coumarin 343 and coumarin 500), such as pyran derivative (for example DCM1 and DCM2), oxazone derivative (for example Nile red), benzothiazole derivative, benzoxazole derivative, benzimidazole derivative, pyrazine derivative, cinnamic acid ester derivative, poly N - vinyl

酸エステル誘導体、ポリーNービニルカルパゾールおよびそ の誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリフェニレ ンおよびその誘導体、ポリフルオレンおよびその誘導体、ポ リフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリビフェニレン ビニレンおよびその誘導体、ポリターフェニレンビニレンお よびその誘導体、ポリナフチレンピニレンおよびその誘導体 、ポリチエニレンピニレンおよびその誘導体など)を少なく とも1種用いて形成することができる。

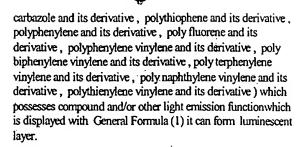
【0032】本発明の有機電界発光素子においては、発光層 に一般式(1)で表される化合物を含有していることが好ま しい。一般式(1)で表される化合物と他の発光機能を有す る化合物を併用する場合、発光層中に占める一般式(1)で 表される化合物の割合は、好ましくは、0.001~99. 999重量%程度、より好ましくは、0.01~99.99 重量%程度、さらに好ましくは、0. 1~99. 9重量%程 度に調製する。

【0033】本発明において用いる他の発光機能を有する化 合物としては、発光性有機金属錯体がより好ましい。例えば 、J. Appl. Phys., 65、3610 (1989) 、特開平5-214 332号公報に記載のように、発光層をホスト化合物とゲス ト化合物(ドーパント)とより構成することもできる。一般 式(1)で表される化合物を、ホスト化合物として用いて発 光層を形成することができ、さらには、ゲスト化合物として 用いて発光層を形成することもできる。一般式 (1) で表さ れる化合物を、ゲスト化合物として用いて発光層を形成する 場合、ホスト化合物としては、発光性有機金属錯体が好まし い。この場合、発光性有機金属錯体に対して、一般式(1) で表される化合物を、好ましくは、0.001~40重量% 程度、より好ましくは、0.01~30重量%程度、特に好 ましくは、0.1~10重量%程度使用する。

【0034】一般式(1)で表される化合物と併用する発光 性有機金属錯体としては、特に限定するものではないが、発 光性有機アルミニウム錯体が好ましく、置換または未置換の 8-キノリノラート配位子を有する発光性有機アルミニウム 錯体がより好ましい。好ましい発光性有機金属錯体としては 、例えば、一般式(a)~一般式(c)で表される発光性有 機アルミニウム錯体を挙げることができる。

$$(Q)_3 - AI$$
 (a)

(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配位子



[0032] Regarding organic electroluminescent element of this in vention, it is desirable to contain compound which in luminescent layer is displayed with General Formula (1). When compound which possesses compound and other light emission function which are displayed with General Formula (1) is jointly used, as for ratio of compound which is displayed with General Formula (1) which is occupied in luminescent layer, the preferably, 0.001 to 99.999 wt% extent, more preferably and 0.01 to 99.99 wt% extent, furthermore it manufactures in preferably and 0.1 to 99.9 wt% extent.

[0033] Regarding to this invention, luminescent organometalli c complex is more desirable as compound which possesses other light emission function which it uses. As stated in for example Journal of Applied Physics (0021-8979, JAPIAU), 65, 3610 (1989) and Japan Unexamined Patent Publication Hei 5 -214332 disclosure, also to constitute with from thehost compound and guest compound (dopant) it is possible luminescent layer. It is possible, furthermore, to form luminescent layer compound which is displayed with General Formula (1), as host compound using, it is possible also toform luminescent layer as guest compound using. When luminescent layer compound which is displayed with General Formula (1), is formedas guest compound using, luminescent organometallic complex is desirable as host compound. In this case, compound which is displayed with General Formula (1) vis-a-visthe luminescent organometallic complex, is used, preferably, 0.001 to 40 wt% extent, more preferably, 0.01 to 30 wt% extent, the particularly preferably and 0.1 to 10 wt% extent.

[0034] It is not something which especially is limited as lumines cent organometallic complex which is jointly used with compound which is displayed with General Formula (1). luminescent organoaluminum complex is desirable, luminescent organoaluminum complex which possesses substituted or unsubstituted 8 - quinolinolato ligand is moredesirable. As desirable luminescent organometallic complex, luminescent organoaluminum complex which is displayed with for example General Formula (a) to General Formula (c)can be listed.

(a) (In Formula, O displays substituted or unsubstituted 8 - quinolin を表す)し、

$$(Q)_2 - AI - O - L$$
 (b)

(式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表し、O-L はフェノラート配位子であり、Lはフェニル部分を含む炭素 数6~24の炭化水素基を表す)

$$(Q_{1})_{2} - A_{1} - O - A_{1} - (Q_{1})_{2}$$
. (c)

(式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表す)

【0035】発光性有機金属錯体の具体例としては、例えば 、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(4 ーメチルー8ーキノリノラート) アルミニウム、トリス (5 ーメチルー8ーキノリノラート) アルミニウム、トリス (3 **, 4ージメチルー8ーキノリノラート) アルミニウム、トリ** ス(4、5ージメチルー8ーキノリノラート)アルミニウム 、トリス(4、6ージメチルー8ーキノリノラート)アルミ ニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(フェノ ラート) アルミニウム、ピス (2ーメチルー8ーキノリノラ ート)(2ーメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 ーメチルー8ーキノリノラート) (3ーメチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2ーメチルー8ーキノリノラート) (4-メチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチ ルー8-キノリノラート) (2-フェニルフェノラート) ア ルミニウム、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)(3 ーフェニルフェノラート) アルミニウム、

【0036】ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4 ーフェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2ーメチル -8-キノリノラート)(2,3-ジメチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)(2. 6-ジメチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチルー8ーキノリノラート) (3,4ージメチルフェノラ ート) アルミニウム、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラー ト) (3. 5ージメチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) (3, 5-ジーtert-ブチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8 ーキノリノラート) (2,6-ジフェニルフェノラート)ア ルミニウム、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)(2 、4、6ートリフェニルフェノラート)アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) (2.4,6-トリメ チルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチルー8-キノリノラート) (2.4.5.6ーテトラメチルフェノラ ート) アルミニウム、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラー ト) (1ーナフトラート) アルミニウム、ピス (2ーメチル -8-キノリノラート) (2-ナフトラート) アルミニウム 、ビス(2、4ージメチルー8ーキノリノラート)(2ーフ ェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2,4ージメチ ルー8ーキノリノラート) (3ーフェニルフェノラート) ア ルミニウム、ビス(2、4ージメチルー8ーキノリノラート) (4-フェニルフェノラート) アルミニウム、ピス (2) 4ージメチルー8ーキノリノラート) (3,5ージメチルフ

olato ligand.)

$$(Q)_2 - Al - O - L$$
 (b)

(In Formula, Q displays substitution 8 - quinolinolato ligand, O - L isthe phenolate ligand, L displays carbon number 6 to 24 hydrocarbon group which includes phenyl portion.)

$$(Q) 2 - Al - O - Al - (Q)2$$
 (c

(In Formula, Q displays substitution 8 - quinolinolato ligand.)

[0035] As embodiment of luminescent organometallic complex, for example tris (8 - quinolinolato) aluminum and tris (4 - methyl - 8 - quinolinolato) aluminum, tris (5 - methyl - 8 - quinolinolato) aluminum, tris (3,4-di methyl - 8 - quinolinolato) aluminum, tris (4,5-di methyl - 8 - quinolinolato) aluminum, tris (4,6-di methyl - 8 - quinolinolato) aluminum, the bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (2 - methyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (3 - methyl phenolate) aluminum, the bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (4 - methyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (2 - phenyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (3 - phenyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (3 - phenyl phenolate) aluminum,

[0036] Bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (4 - phenyl phen olate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (2,3di methyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 quinolinolato) (2,6-di methyl phenolate) aluminum, bis (2methyl - 8 - quinolinolato) (3,4-di methyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (3,5-di methyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 quinolinolato) (3,5-di - t-butyl phenolate) aluminum, bis (2 methyl - 8 - quinolinolato) (2,6-di phenyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (2,4,6 triphenyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 quinolinolato) (2,4,6 - trimethyl phenolate) aluminum, bis (2 methyl - 8 - quinolinolato) (2,4,5,6 - tetramethyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (1 naphtholate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (2 - naphtholate) aluminum, bis (2,4-di methyl - 8 quinolinolato) (2 - phenyl phenolate) aluminum, bis (2,4-di methyl - 8 - quinolinolato) (3 - phenyl phenolate) aluminum, bis (2,4-di methyl - 8 - quinolinolato) (4 phenyl phenolate) aluminum, bis (2,4-di methyl - 8 quinolinolato) (3,5-di methyl phenolate) aluminum, bis (2,4di methyl - 8 - quinolinolato) (3,5-di - t-butyl phenolate) aluminum,

ェノラート) アルミニウム、ビス (2、4ージメチルー8ーキノリノラート) (3、5ージーtertープチルフェノラート) アルミニウム、

【0037】 ピス(2ーメチルー8ーキノリノラート)アル ミニウム-ルーオキソーピス(2-メチルー8-キノリノラ ート) アルミニウム、ビス(2. 4ージメチルー8ーキノリ ノラート) アルミニウムーμーオキソーピス(2. 4ージメ チルー8ーキノリノラート) アルミニウム、ピス(2ーメチ ルー4ーエチルー8ーキノリノラート) アルミニウムーμー オキソービス (2-メチル-4-エチル-8-キノリノラー ト) アルミニウム、ビス(2ーメチルー4ーメトキシー8ー キノリノラート) アルミニウムーμーオキソーピス(2ーメ チルー4ーメトキシー8ーキノリノラート) アルミニウム、 ビス(2ーメチルー5ーシアノー8ーキノリノラート)アル ミニウムールーオキソービス(2ーメチルー5ーシアノー8 ーキノリノラート) アルミニウム、ピス(2ーメチルー5ー トリフルオロメチルー8ーキノリノラート) アルミニウムー **μーオキソーピス(2ーメチルー5ートリフルオロメチルー** 8-キノリノラート) アルミニウムなどを挙げることができ る。勿論、発光性有機金属錯体は、単独で使用してもよく、 あるいは複数併用してもよい。

【0038】電子注入輸送層5は、陰極からの電子の注入を 容易にする機能、そして注入された電子を輸送する機能を有 する化合物を含有する層である。電子注入輸送層は、一般式 (1) で表される化合物および/または他の電子注入輸送機 能を有する化合物(例えば、有機金属錯体〔例えば、トリス (8-キノリノラート) アルミニウム、ピス(10-ペンソ [h] キノリノラート) ベリリウム]、オキサジアゾール誘導 体、トリアゾール誘導体、トリアジン誘導体、ペリレン誘導 体、キノリン誘導体、キノキサリン誘導体、ジフェニルキノ ン誘導体、ニトロ置換フルオレノン誘導体、チオピランジオ キサイド誘導体など)を少なくとも1種用いて形成すること ができる。本発明の有機電界発光素子においては、電子注入 輸送層に、一般式 (1) で表される化合物を含有しているこ とが好ましい。一般式 (1) で表される化合物と他の電子注 入輸送機能を有する化合物を併用する場合、電子注入輸送層 中に占める本発明に係る一般式(1)で表される化合物の割 合は、好ましくは、0. 1重量%以上、より好ましくは、0 . 1~40重量%程度、さらに好ましくは、0.2~30重 量%程度、特に好ましくは、0.5~20重量%程度に調製 する。本発明においては、一般式(1)で表される化合物と 有機金属錯体〔例えば、前記一般式(a)~一般式(c)で 表される化合物】を併用して、電子注入輸送層を形成するこ とは好ましい。

[0037] Bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) aluminum - oxo-bis (2-methyl-8-quinolinolato) aluminum, bis (2,4-di methyl - 8 - quinolinolato) aluminum - - oxo bis (2,4-di methyl - 8 - quinolinolato) aluminum, bis (2 methyl - 4 - ethyl - 8 - quinolinolato) alununum - oxo - bis (2 - methyl - 4 - ethyl - 8 - quinolinolato) aluminum, bis (2 - methyl - 4 - methoxy - 8 quinolinolato) aluminum - - oxo - bis (2 - methyl - 4 methoxy - 8 - quinolinolato) aluminum, bis (2 - methyl -5 - cyano - 8 - quinolinolato) aluminum - - oxo - bis (2 - methyl - 5 - cyano - 8 - quinolinolato) aluminum and bis (2 - methyl - 5 - trifluoromethyl - 8 - quinolinolato) aluminum - - oxo -bis (2 - methyl - 5 trifluoromethyl - 8 - quinolinolato) aluminum etc can be listed. Of course, it is possible to use luminescent organometallic complex, with alone, or theplural to jointly use is possible.

[0038] Electron-implanted transport layer 5 makes fill of electr on from cathode easy is layer which contains compound which possesses function which transportsthe electron which functioned, and was filled and. at least 1 kind using compound (Such as for example organometallic complex (for example tris (8 - quinolinolato) aluminum and bis (10 - benzo [h] quinolinolato) beryllium), oxadiazole derivative, triazole derivative, triazine derivative, perylene derivative, quinoline derivative, quinoxaline derivative, biphenyl quinone derivative, nitro-substituted fluorenone derivative and thiopyran dioxide derivative) which possesses compound and/or other electron-implanted transport functionwhich is displayed with General Formula (1) it can form electron-implanted transport layer. Regarding organic electroluminescent element of this invention, in electron-implanted transport layer, it is desirable tocontain compound which is displayed with General Formula (1). When compound which possesses compound and other electron-implanted transport function which are displayed with General Formula (1) is jointly used, as for ratio of compoundwhich is displayed with General Formula (1) which relates to this invention which isoccupied in electron-implanted transport layer, preferably, 0.1 weight% or greater, more preferably and 0.1 to 40 wt% extent , furthermore it manufactures in preferably, 0.2 to 30 wt% extent, particularly preferably and the 0.5 to 20 wt% extent. Regarding to this invention, jointly using compound and organometallic complex (compound which with for example aforementioned General Formula (a) to General Formula (c) is displayed) which aredisplayed with General Formula (1), it is desirable to form electron-implanted transport layer.

【0039】陰極6としては、比較的仕事関数の小さい金属、合金または電気電導性化合物を電極物質として使用することが好ましい。陰極に使用する電極物質としては、例えば、リチウム、リチウムーインジウム合金、ナトリウム、ナトリウムーカリウム合金、カルシウム、マグネシウムー銀合金、マグネシウムーインジウム合金、インジウム、ルテニウム、チタニウム、マンガン、イットリウム、アルミニウム、アルミニウムーリチウム合金、アルミニウムーカルシウム合金、アルミニウムーマグネシウム合金、グラファイト薄膜等を挙げることができる。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0040】陸極は、これらの電極物質を、例えば、蒸着法、スパッタリング法、イオン化蒸着法、イオンプレーティング法、クラスターイオンピーム法等の方法により、電子注入輸送層の上に形成することができる。また、陸極は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。尚、陰極のシート電気抵抗は、数百Q/口以下に設定するのが好ましい。陰極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般に、5~1000nm程度、より好ましくは、10~500nm程度に設定する。尚、有機電界発光素子の発光を効率よく取り出すために、陽極または陰極の少なくとも一方の電極が、透明ないし半透明であることが好ましく、一般に、発光光の透過率が70%以上となるように陽極の材料、厚みを設定することがより好ましい。

【0041】また、本発明の有機電界発光素子においては、 その少なくとも一層中に、一重項酸素クエンチャーが含有さ れていてもよい。一重項酸素クエンチャーとしては、特に限 定するものではなく、例えば、ルブレン、ニッケル錯体、ジ フェニルイソペンゾフランなどが挙げられ、特に好ましくは 、ルブレンである。一重項酸素クエンチャーが含有されてい る層としては、特に限定するものではないが、好ましくは、 発光層または正孔注入輸送層であり、より好ましくは、正孔 注入輸送層である。尚、例えば、正孔注入輸送層に一重項酸 素クエンチャーを含有させる場合、正孔注入輸送層中に均一 に含有させてもよく、正孔注入輸送層と隣接する層(例えば 、発光層、発光機能を有する電子注入輸送層)の近傍に含有 させてもよい。一重項酸素クエンチャーの含有量としては、 含有される層(例えば、正孔注入輸送層)を構成する全体量 の0.01~50重量%、好ましくは、0.05~30重量 %、より好ましくは、0.1~20重量%である。1

[0039] As cathode 6, as electrode substance, it is desirable to use metal, the alloy or electrical conductivity compound where work function is small relatively. for example lithium and lithium - indium alloy, sodium and sodium - potassium alloy, the calcium, magnesium and magnesium - silver alloy, magnesium - indium alloy, the indium, ruthenium, titanium, manganese, yttnium, aluminum and the aluminum - lithium alloy, aluminum - calcium alloy, aluminum - magnesium alloy and graphite thin filmete can be listed as electrode substance which is used for cathode. It is possible to use these electrode substance, with alone, or plural tojointly use is possible.

[0040] It can form cathode, on electron-implanted transport la yer these electrode substance, with for example vapor deposition method, the sputtering method, ionization vapor deposition method, ion plating method and cluster ion beam method or other method. In addition, cathode may be structure more, or to be multilayer structure ispossible. Furthermore as for sheet electrical resistance of cathode, it is desirableto set to several hundred /square or below. thickness of cathode, it depends on also material of electrode substancewhich is used, but generally, it sets to 5 to 1000 nm extent, more preferably and the 10 to 500 nm extent. Furthermore in order to remove light emission of organic electroluminescent elementefficiently, electrode of at least one of anode or cathode, being a transparent or semitransparent isdesirable, in order generally, for transmittance of emitted light to becomethe 70 % or higher, material of anode, it is more desirable to set the thickness.

[0041] In addition, in at least one layer, singlet oxygen quench er may be contained regarding theorganic electroluminescent element of this invention. As singlet oxygen quencher, it is not something which especially is limited, you canlist for example rubrene, nickel complex and biphenyl isobenzofuran etc, it is a particularly preferably and a rubrene. It is not something which especially is limited as layer where the singlet oxygen quencher is contained. It is a preferably, a luminescent layer or a positive hole injection transport layer, is a more preferably and a positive hole injection transport layer. Furthermore when singlet oxygen quencher is contained in for example positive hole injection transport layer, it is possible to uniform to contain in positive hole injection transport layer, to vicinity of the positive hole injection transport layer and adjacent layers (It possesses for example luminescent layer and light emission function electron-implanted transport layer) to contain is possible. As content of singlet oxygen quencher, 0.0 1 to 5 0 wt% of entire amount whichforms layer (for example positive hole injection transport layer) which is contained, it is a preferably, a 0.05 to 30 wt%, a more preferably and a 0.1 to 20 wt%.

【0042】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の形 成方法に関しては、特に限定するものではなく、例えば、真 空蒸着法、イオン化蒸着法、溶液塗布法(例えば、スピンコ ート法、キャスト法、ディップコート法、パーコート法、ロ ールコート法、ラングミュア・プロゼット法など) により薄 膜を形成することにより作製することができる。真空蒸着法 により、各層を形成する場合、真空蒸着の条件は、特に限定 するものではないが、10-5 Torr 程度以下の真空下で、5 0~400℃程度のポート温度(蒸着源温度)、-50~3 00℃程度の基板温度で、0.005~50nm/sec 程度 の蒸着速度で実施することが好ましい。この場合、正孔注入 輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層は、真空下で、連 続して形成することにより、諸特性に一層優れた有機電界発 光素子を製造することができる。真空蒸着法により、正孔注 入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層を、複数の化合 物を用いて形成する場合、化合物を入れた各ポートを個別に 温度制御して、共蒸着することが好ましい。

【0043】溶液塗布法により、各層を形成する場合、各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂等を、線に溶解、または分散させて塗布液とする。正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の各層に使用しうるバインダー樹脂としては、ポリーNービニルカルバゾール、ポリート、ポリート、ポリエステル、ポリン・ポリエステル、ポリアリレート、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリフェニレンオキサイド、ポリエーテル、ポリフェニレンオキサイド、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリチオーフェンおよびその誘導体、ポリチオーフェンおよびその誘導体、ポリチオーフェンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエーレンおよびその誘導体、ポリチエーレンおよびその誘導体、ポリテエニレンが表導体、ポリフェーレンが表導体、ポリテエニレンが表導体、ポリテエニレンが表導体、が挙げられる。バインダー樹脂は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0044】溶液塗布法により、各層を形成する場合、各層を形成する成分あるいはその成分とパインダー樹脂等を、適当な有機溶媒(例えば、ヘキサン、オクタン、デカン、トルエシ、キシレン、エチルペンゼン、1ーメチルナフタレン等の炭化水素系溶媒、例えば、アセトン、メチルエチルケトン系溶媒、例えば、ジクロロメタン、クロロホルム、テトラクロロメタン、ジクロロベンゼン、ジクロロベンゼン、クロロトルエン等のハロゲン化炭化水素系溶媒、例えば、酢酸エチル、エン等のハロゲン化炭化水素系溶媒、例えば、酢酸エチル、

[0042] In regard to formation method of positive hole injectio n transport layer, luminescent layer and electron-implanted transport layer, it is not something which especially is limited, it can produce by formingthe thin film with for example vacuum vapor deposition method, ionization vapor deposition method and solution coating method (for example spin coating method, casting method, dip coating method, barcoat method and roll coating method, such as Langmuiiプロゼ v ip7method). With vacuum vapor deposition method, when each layer is formed, condition of vacuum vapor deposition is not something which especially is limited. Under vacuum of 10-5 Torr extent or less, boat temperature (vapor deposition source temperature) of 50 to 400 °C extent, with substrate temperature of -50 to 300 °C extent, it is desirable to execute with vapor deposition rate of 0.005 to 50 nm/sec extent. In this case, positive hole injection transport layer, luminescent layer and electron-implanted transport layer or other each layer, under the vacuum, continuing, can produce organic electroluminescent element which is superior more in the characteristics by forming. When it forms with vacuum vapor deposition method, positive hole injection transport layer, luminescent layer and electron-implanted transport layer or other eachlayer, making use of compound of multiple, temperature control doing eachboat which inserted compound individually, codeposition it is desirableto do.

[0043] With solution coating method, when each layer is form ed, component which forms eachlayer or component and binder resin etc. melting in solvent, ordispersing it makes coating solution. positive hole injection transport layer, luminescent layer, You can list for example poly N - vinyl carbazole, polyarylate, polystyrene, polyester, polysiloxane, the poly methyl acrylate, poly methyl methacrylate, polyether, polycarbonate, polyamide, polyimide, the polyamideimide, poly paraxylene, polyethylene, polyphenylene oxide, polyether sulfone, polyaniline and theits derivative, polythiophene and its derivative, polyphenylene vinylene and its derivative, poly fluorene andthe its derivative, polythienylene vinylene and its derivative or other polymeric compound as binder resin which it can use foreach layer of electron-implanted transport layer. It is possible to use binder resin, with alone, or multiple tojointly use is possible.

[0044] With solution coating method, when each layer is form ed, component which forms each layer or component and binder resin etc, melting in suitable organic solvent (for example hexane, octane, decane, toluene, xylene, ethyl benzene, 1 - methyl naphthalene or other hydrocarbon solvent, for example acetone, methylethylketone, methyl isobutyl ketone, cyclohexanone or other ketone solvent, for example dichloromethane, chloroform, tetrachloro methane, dichloroethane, trichloroethane, tetrachloroethane, chlorobenzene, dichlorobenzene, chlorotoluene or other

酢酸ブチル、酢酸アミル等のエステル系溶媒、例えば、メタノール、プロパノール、ブタノール、ベンタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチレングリコール等のアルコール系溶媒、例えば、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、アニソール等のエーテル系溶媒、例えば、N. Nージメチルホルムアミド、N. Nージメチルアセトアミド、1ーメチルー2ーピロリドン、1、3ージメチルー2ーイミダゾリジノン、ジメチルスルフォキサイド等の極性溶媒)および/または水に溶解、または分散させて塗布液とし、各種の塗布法により、薄膜を形成することができる。

【0045】尚、分散する方法としては、特に限定するものではないが、例えば、ボールミル、サンドミル、ペイントシェーカー、アトライター、ホモジナイザー等を用いて微粒子状に分散することができる。塗布液の濃度に関しては、特に限定するものではなく、実施する塗布法により、所望の厚みを作製するに適した濃度範囲に設定することができ、一般には、0.1~50重量%程度、好ましくは、1~30重量%程度の溶液濃度である。尚、パインダー樹脂を使用する場合、その使用量に関しては、特に限定するものではないが、一般には、各層を形成する成分に対して(一層型の素子を形成する場合には、各成分の総量に対して)、5~99.9重量%程度、好ましくは、10~99重量%程度、より好ましくは、15~90重量%程度に設定する。

【0046】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の膜 厚に関しては、特に限定するものではないが、一般に、5 n m~5μm程度に設定することが好ましい。尚、作製した素 子に対し、酸素や水分等との接触を防止する目的で、保護層 (封止層)を設けたり、また素子を、例えば、パラフィン、 流動パラフィン、シリコンオイル、フルオロカーボン油、ゼ オライト含有フルオロカーボン油などの不活性物質中に封入 して保護することができる。保護層に使用する材料としては 、例えば、有機高分子材料(例えば、フッ素化樹脂、エポキ シ樹脂、シリコーン樹脂、エポキシシリコーン樹脂、ポリス チレン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポ リイミド、ポリアミドイミド、ポリパラキシレン、ポリエチ レン、ボリフェニレンオキサイド)、無機材料(例えば、ダ イヤモンド薄膜、アモルファスシリカ、電気絶縁性ガラス、 金属酸化物、金属窒化物、金属炭素化物、金属硫化物)、さ らには光硬化性樹脂などを挙げることができ、保護層に使用 する材料は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用して もよい。保護層は、一層構造であってもよく、また多層構造 であってもよい。

halogenated hydrocarbon solvent, for example ethyl acetate, butyl acetate, amyl acetate or other ester type solvent, for example methanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, cyclohexanol, methyl cellosolve, ethyl cellosolve, ethyleneglycol or other alcoholic solvent, for example dibutyl ether, tetrahydrofuran, dioxane, anisol or other ether solvent, for example N,N-dimethylformamide, N,N-dimethylacetamide and 1 - methyl - 2 - pyrrolidone, 1,3-di methyl - 2 - imidazolidinone, dimethyl sulfoxide or other polar solvent) and/orwater, or dispersing it makes coating solution, it can form thin film withthe various painting method.

[0045] Furthermore it is not something which especially is limit ed as themethod which is dispersed. It can disperse to fine particulate state making use of for example ball mill, sand mill, the paint shaker, attritor and homogenizer etc. In regard to concentration of coating solution, it is not something whichespecially is limited, desired thickness is produced it is possible with thepainting method which is executed, to set to concentration range which is suitedgenerally, it is a solution concentration of 0.1 to 50 weight% extent, preferably and 1 to 30 weight% extent. Furthermore when binder resin is used, it is not somethingwhich especially is limited in regard to amount used. Generally, vis-a-vis component which forms each layer (When element of single layer type is formed, in total weight of each component confronting), it sets to he 5 to 99.9 weight% extent, preferably, 10 to 99 weight% extent, more preferably and 15 to 90 weight% extent.

[0046] In regard to film thickness of positive hole injection tra nsport layer, luminescent layer and electron-implanted transport layer, it is not something which especially is limited. Generally, it is desirable to set to 5 nm to 5 m extent. Furthermore with objective which prevents contact with the oxygen and moisture etc vis-a-vis element which is produced, the protective layer (stop layer) is provided, in addition element, is enclosed in for example paraffin, the liquid paraffin, silicon oil, fluorocarbon oil and zeolite content fluorocarbon oil or other inactive substance and it canprotect. for example organic polymeric material (for example fluorinated resin, epoxy resin, silicone resin, epoxy silicone resin, polystyrene, polyester, polycarbonate, polyamide, polyimide, polyamideimide, poly paraxylene, polyethylene and polyphenylene oxide), inorganic material (for example diamond thin film, amorphous silica, electrically insulating glass, metal oxide, metal nitride, metal carbonized substance and metal sulfide), furthermore it can list photocurable resin etc asthe material which is used for protective laver, with alone to use material which is used for protective layer, it is possible, or plural to jointly use is possible. protective layer may be structure more, in addition to be multilayer structureis possible.

【0047】また、電極に保護膜として、例えば、金属酸化 膜(例えば、酸化アルミニウム膜)、金属フッ化膜を設ける こともできる。また、例えば、陽極の表面に、例えば、有機 リン化合物、ポリシラン、芳香族アミン誘導体、フタロシア ニン誘導体から成る界面層(中間層)を設けることもできる 。さらに、電極、例えば、陽極はその表面を、例えば、酸、 アンモニア/過酸化水素、あるいはブラズマで処理して使用 することもできる。

【0048】本発明の有機電界発光素子は、一般に、直流駆動型の素子として使用されるが、パルス駆動型または交流駆動型の素子としても使用することができる。尚、印加電圧は、一般に、2~30V程度である。本発明の有機電界発光素子は、例えば、パネル型光源、各種の発光素子、各種の表示素子、各種の標識、各種のセンサーなどに使用することができる。

[0049]

٠٠ .

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、勿論、本発明はこれらに限定されるものではない。

実施例11

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基 板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄 した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オ ゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸 着椿を3×10~ Torr に減圧した。まず、ITO透明電極 上に、4、4^{*} ーピス(NーフェニルーNー(1^{*} ーナフチ ル) アミノ] ビフェニルを、蒸着速度 O. 2 n m/sec で 7 5 nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、そ の上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムと第1 表に示す化合物(1-1)(以下、同じ)を、異なる蒸着源 から、蒸着速度O. 2nm/sec で50nmの厚さに共蒸着 (重量比100:0.5) し、発光層とした。次に、トリス (8-キノリノラート) アルミニウムを、蒸着速度 0.2 n m/sec で50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした 。さらにその上に、マグネシウムと銀を蒸着速度 0.2 nm /sec で200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1) して 陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着 槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光 素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ 、58mA/cm² の電流が流れた。輝度2240cd/m 2 の赤橙色の発光が確認された。

[0047] In addition, is possible also fact that for example oxidiz ed metal film (for example aluminum oxide film) and metal fluoride filmare provided as protective film, to electrode. In addition, to surface of for example anode, is possible also fact thatthe interfacial layer (intermediate layer) which consists of for example organophosphorus compound, poly silane, aromatic amine derivative and the phthalocyanine derivative is provided. Furthermore, electrode and for example anode can also use treating surface, with for example acid, ammonia / hydrogen peroxide or plasma.

[0048] It is used as for organic electroluminescent element of the is invention, generally, as element of direct current drive type, but as element of pulse drive type or alternating current drive type you can use. Furthermore applied voltage, generally, is 2 to 30V extent. for example panel type light source, various luminescent element, various display element, you can use organic electroluminescent element of this invention, for various label and various sensor etc.

[0049]

[Working Example(s)] This invention furthermore is explained in detail below, with Working Example ,but it is not something where of course, this invention is limited in hese.

Working Example 1

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm, making use of neutral detergent, acetone and ethanol, substrate was dried making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozoneafter washing, after locking in substrate holder of vapor deposition equipment, vapor deposition tankthe vacuum was done in 3 X 10-6 Torr. First, on ITO transparent electrode, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 4, 4' - bis (N - phenyl- N - (1° - naphthyl) amino) biphenyl, in thickness of 75 nm, made positive hole injection transport layer. Next, on that, from vapor deposition source which differs, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 100:0.5)it did compound (1 - 1) (Below, same) which is shown in tris (8 - quinolinolato) aluminum and Table 1, in thethickness of 50 nm, made luminescent layer. Next, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did tris (8 - quinolinolato) aluminum, in thickness of the 50 nm, made electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and thesilver in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor depositiontank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of

[0050] 実施例2~14

実施例1において、発光層の形成に際して、化合物(1-1)を使用する代わりに、化合物(1-2~1-14)を使用した以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。それぞれの素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、赤橙色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第2表(表4)に示した。

【0051】比較例1

実施例1において、発光層の形成に際して、化合物(1-1)を使用せずに、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムだけを用いて、50nmの厚さに蒸着し、発光層とした以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。この素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、緑色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第2表に示した。

【0052】比較例2

実施例1において、発光層の形成に際して、化合物(1-1)を使用する代わりに、1.3.5.7.8-ペンタメチル-4.4-ジフルオロー4ーボラー3a.4a-ジアザーsーインダセンを使用した以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。この素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、緑色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第2表に示した。

[0053]

12V, current of 58 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 2240 cd/m2 was verified.

[0050] Working Example 2 to 14

In Working Example 1, at time of formation of luminescent la yer, other thanusing compound (1 - 2 to 1 - 14) for substituting which uses compound (1 - 1), organic electroluminescent elementwas produced with method which is stated in Working Example 1. In respective element, under dry atmosphere, when imparting it does the direct current voltage of 12V, light emitting of reddisk amber was verified. Furthermore characteristic was inspected, result was shown in the Table 2 (Table 4).

[0051] Comparative Example 1

In Working Example 1, at time of formation of luminescent la yer, without using the compound (1 - 1), vapor deposition it did in thickness of 50 nm making use of just tris (8 - quinolinolato) aluminum, other than making luminescent layer, it produced organic electroluminescent element with method which is stated in Working Example 1. In this element, under dry atmosphere, when imparting it does direct current voltage of the 12V, light emitting of green color was verified. Furthermore characteristic was inspected, result was shown in the Table 2.

[0052] Comparative Example 2

In Working Example 1, at time of formation of luminescent layer, other thanusing 1,3,5,7,8 - pentamethyl - 4,4-di fluoro - 4 - bora - 3a,4a-di aza - s - indacene for the substituting which uses compound (1 - 1), organic electroluminescent element was produced with themethod which is stated in Working Example 1. In this element, under dry atmosphere, when imparting it does direct current voltage of the 12V, light emitting of green color was verified. Furthermore characteristic was inspected, result was shown in the Table 2.

[0053]

第2表

有機電界 発光素子	輝度 (cd/m²)	電流密度 (mA/cm²)
実施例 2	2 2 6 0	60
実施例 3	2240	54
実施例 4	2230	61
実施例 5	2260	56
実施例 6	2320	. 57
実施例 7	2250	5.5
実施例 8	2300	5 6
実施例 9	2230	5 9
実施例10	2290	.5 5
実施例11	2350	5 5
実施例12	2300	5 6
実施例13	2260	60
実施例14	2320	6 1
比较例1	1170	8 2
比較例2	1550	60

【0054】実施例15

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基 板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄 した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オ ゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸 着槽を3×10-6 Torr に減圧した。まず、ITO透明電極 上に、4. 4'ーピス [NーフェニルーNー(3"ーメチル フェニル)アミノ] ピフェニルを、蒸着速度 0.2 n m/se : c で75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次い で、その上に、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウム と化合物(1-23)を、異なる蒸着源から、蒸着速度0. 2 nm/sec で50nmの厚さに共蒸着(重量比100:1 . 0) し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラー ト) アルミニウムを、蒸着速度 O. 2 nm/sec で 5 0 nm の厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、 マグネシウムと銀を蒸着速度0.2nm/sec で200nm の厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界 発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保っ たまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気 下、12Vの直流電圧を印加したところ、58mA/cm² の電流が流れた。輝度1950cd/m² の赤橙色の発光が 確認された。

[0054] Working Example 15

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm, making use of neutral detergent, acetone and ethanol, substrate was dried making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozoneafter washing, after locking in substrate holder of vapor deposition equipment, vapor deposition tankthe vacuum was done in 3 X 10-6 Torr . First, on ITO transparent electrode, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 4, 4' - bis (N-phenyl-N-(3'-methylphenyl) amino) biphenyl, in thickness of 75 nm, made positive hole injection transport layer. Next, on that, from vapor deposition source which differs, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 100:1.0)it did tris (8 - quinolinolato) aluminum and compound (1 - 23), in thickness of 50 nm, made the luminescent layer. Next, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did tris (8 - quinolinolato) aluminum, in thickness of the 50 nm, made electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and thesilver in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor

[0055] 実施例16

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基 板を、中性洗剤、アセトン、エタノ一ルを用いて超音波洗浄 した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オー ゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸 着槽を3×10−6 Torr に減圧した。まず、ITO透明電極 に、4、4゜ービス〔NーフェニルーNー(3゜ーメチルフ・ ェニル) アミノ] ビフェニルを、蒸着速度 O. 2 n m/sec で75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで 、その上に、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)アル ミニウムーμーオキソービス(2-メチルー8-キノリノラ ート) アルミニウムと化合物(1-27)を、異なる蒸着源 から、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの厚さに共蒸着 (重量比100:2.0) し、発光層とした。次に、トリス (8-キノリノラート) アルミニウムを、蒸着速度 0.2 n m/sec で50mmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした 。さらにその上に、マグネシウムと銀を蒸着速度 0.2 nm /sec で200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して 陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着 槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光 素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ 、60mA/cm²の電流が流れた。輝度2010cd/m 2 の赤橙色の発光が確認された。

【0056】実施例17

厚さ200 nmの I T O透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。まず、I T O透明電極上に、4.4'ーピス [NーフェニルーNー(3"ーメチルフェニル)アミノ] ピフェニルを、蒸着速度0.2 nm/secで75 nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。パーフェニルに、ピス(2、4ージメチルー8ーキノリノラート)アルミニウムー μ ーオキソービス(2、4ージメチルー8ーキノリノラート)アルミニウムラート)アルミニウムと化合物(1ー16)を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2 nm/secで50 nmの厚さに共蒸着(重量比100:4.0)し、発光層とした。次に、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウムを、蒸

deposition tank was mainted. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting it does direct current voltage of 12V, current of 58 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 1950 cd/m2 was verified.

[0055] Working Example 16

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm, making use of neutral detergent, acetone and ethanol. substrate was dried making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozoneafter washing, after locking in substrate holder of vapor deposition equipment, vapor deposition tankthe vacuum was done in 3 X 10-6 Torr . First, in ITO transparent electrode, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 4, 4' - bis (N - phenyl- N - (3" - methylphenyl) amino) biphenyl, in thickness of 75 nm, made positive hole injection transport layer. Next, on that, from vapor deposition source which differs, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 100:2.0)it did bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) aluminum - - oxo - bis (2 - methyl - 8 quinolinolato) aluminum and compound (1 - 27), in the thickness of 50 nm, made luminescent layer. Next, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did tris (8 quinolinolato) aluminum, in thickness of the 50 nm, made electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and thesilver in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor depositiontank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 12V, current of 60 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 2010 cd/m2 was verified.

[0056] Working Example 17

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO transparent electrode (anode) of thickness 200 nm,making use of neutral detergent, acetone and ethanol. substrate was dried making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozoneafter washing, after locking in substrate holder of vapor deposition equipment, vapor deposition tankthe vacuum was done in 3 X 10-6 Torr. First, on ITO transparent electrode, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 4, 4'-bis (N-phenyl-N-(3"-methylphenyl) amino) biphenyl, in thickness of 75 nm, made positive hole injection transport layer. Next, on that, from vapor deposition source which differs, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 100:4.0)it did bis (2,4-di methyl-8-quinolinolato) aluminum--oxo-bis (2,4-di methyl-

着速度 0.2 nm/sec で50 nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を蒸着速度 0.2 nm/sec で200 nmの厚さに共蒸着(童量比10:1)して陰極とし、有機電界免光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界免光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ、61 mA/cm²の電流が流れた。輝度 1970 c d/m²の赤根色の免光が確認された。

[0057] 実施例18

厚さ200mmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基 板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄 した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オ ゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸 着槽を3×10~ Torr に減圧した。まず、1TO透明電模 上に、4. 4' ーピス(NーフェニルーNー(3" ーメチル ·フェニル)アミノ〕ビフェニルを、蒸着速度0.2nm/se c で75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次い で、その上に、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウム と化合物(1-29)を、異なる蒸着源から、蒸着速度0. 2 n m/sec で50 n mの厚さに共蒸着(重量比100:1 . 0) し、電子注入輸送層を兼ねた発光層とした。さらにそ の上に、マグネシウムと銀を蒸着速度 O. 2 n m/sec で 2 00 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、 有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状 態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾 燥雰囲気下、42Vの直流電圧を印加したところ、58mA / c m² の電流が流れた。輝度1950cd/m² の赤橙色| の発光が確認された。

[0058] 実施例19

厚さ200 nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基版を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4'ーピス【NーフェニルーNー(3"ーメチルフェニル)アミノ】ビフェニルを、蒸着速度0.2 nm/secで75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次い

-8 - quinolinolato) aluminum and compound (1 - 16), in the thickness of 50 nm, made luminescent layer. Next, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did tris (8 - quinolinolato) aluminum, in thickness of the 50 nm, made electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and the silver in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor depositiontank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 12V, current of 61 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 1970 cd/m2 was verified.

[0057] Working Example 18

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm, making use of neutral detergent, acetone and ethanol, substrate was dried making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozoneafter washing, after locking in substrate holder of vapor deposition equipment, vapor deposition tankthe vacuum was done in 3 X 10-6 Torr . First, on ITO transparent electrode, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 4, 4' - bis (N-phenyl-N-(3*-methylphenyl) amino) biphenyl, in thickness of 75 nm, made positive hole injection transport layer. Next, on that, from vapor deposition source which differs, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 100:1.0)it did tris (8 - quinolinolato) aluminum and compound (1 - 29), in thickness of 50 nm, it made theluminescent layer which combines electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and thesilver in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor depositiontank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 12V, current of 58 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 1950 cd/m2 was verified.

[0058] Working Example 19

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO transparent electrode (anode) of thickness 200 nm, making use of neutral detergent, acetone and ethanol. substrate was dried making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozoneafter washing, after locking in substrate holder of vapor deposition equipment, vapor deposition tankthe vacuum was done in 3 X 10-6 Torr. First, on ITO transparent electrode, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 4, 4'- bis

で、その上に、1、1、4、4ーテトラフェニルー1、3ープタジエンを、蒸着速度 0、2 nm/sec で50 nmの厚さに蒸着し、発光層とした。次いで、その上に、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウムと化合物(1ー1)を、異なる蒸着源から、蒸着速度 0、2 nm/sec で50 nmの厚さに共蒸着(重量比100:4.0)し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0、2 nm/sec で200 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、14 Vの直流電圧を印加したところ、52mA/cm²の電流が流れた。輝度2270cd/m²の青色の発光が確認された。

[0059] 実施例20

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基 板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄 した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オ ゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸 着槽を3×10⁻⁵ Torr に減圧した。まず、ITO透明電極 上に、4.4'ーピス〔NーフェニルーNー(3"ーメチル フェニル) アミノ] ピフェニルを、蒸着速度 0.2 n m/se c で75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次い で、その上に、化合物(1-14)を、蒸着速度0.2nm /sec で50mmの厚さに蒸着し、発光層とした。次いで、 その上に、1, 3ービス [5'ー(p-tertーブチルフェニ ル) -1、3、4-オキサジアゾール-2' -イル] ベンゼ ンを、蒸着速度 O. 2 n m / sec で 5 0 n m の厚さに蒸着し 、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと 銀を蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nmの厚さに共蒸着 (重量比10:1) して陰極とし、有機電界発光素子を作製 した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した 。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、14Vの直 流電圧を印加したところ、49mA/cm2の電流が流れた 。輝度1990cd/m²の赤橙色の発光が確認された。

【0060】実施例21

厚さ200mmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基

(N-phenyl-N-(3'-methyrphenyl) amino) biphenyl, in thickness of 75 nm, made positive hole injection transport layer. Next, on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 1,1,4,4 - tetra phenyl - 1,3 - butadiene, in the thickness of 50 nm, made luminescent layer. Next, on that, from vapor deposition source which differs, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 100:4. 0)it did tris (8 - quinolinolato) aluminum and compound (1 - 1), in thickness of 50 nm, made the electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and thesilver, in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor depositiontank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 14V, current of 52 mA/cm2 flowed. light emission of blue of luminance 2270 cd/m2 was verified.

[0059] Working Example 2 0

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm, making use of neutral detergent, acetone and ethanol. substrate was dried making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozoneafter washing, after locking in substrate holder of vapor deposition equipment, vapor deposition tankthe vacuum was done in 3 X 10-6 Torr . First, on ITO transparent electrode, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 4, 4'- bis (N - phenyl- N - (3" - methylphenyl) amino) biphenyl, in thickness of 75 nm, made positive hole injection transport layer. Next, on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did compound (1 - 14), in thicknessof 50 nm, made luminescent layer. Next, on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 1,3 - bis (5'-(p-t-butyl phenyl) - 1,3,4 - oxadiazole -2'-yl) benzene, in thickness of 50 nm, made electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and thesilver in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor depositiontank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 14V, current of 49 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 1990 cd/m2 was verified.

[0060] Working Example 2 1

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra

板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄 した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オ ゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸 着椿を3×10-6 Torr に滅圧した。まず、ITO透明電極 上に、化合物(1-10)を、蒸着速度 0. 2 nm/secで … 55nmの厚さに蒸着し、発光層とした。次いで、その上に 、1、3-ビス (5'- (p-tertープチルフェニル) -1 , 3, 4-オキサジアゾール-2' -イル] ペンゼンを、蒸 着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸着し、電子注 入輸送磨とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を蒸着 速度の、2nm/sec で200nmの厚さに共蒸着(重量比 10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚 、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製し た有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、15∨の直流電圧を 印加したところ、68mA/cm²の電流が流れた。輝度1 150cd/m²の赤橙色の発光が確認された。

[0061] 実施例22

厚さ200mmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基 板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄 した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オ ゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上に、ポリーN-ビニ ルカルパゾール(重量平均分子量 1 5 0 0 0 0)、1、1. 4. 4ーテトラフェニルー1. 3ープタジエン(育色の発光 成分)、クマリン6〔"3-(2'-ベンゾチアゾリル)-**フージエチルアミノクマリン"(緑色の発光成分)〕、およ** び化合物(1-5)を、それぞれ重量比100:5:3:2 の割合で含有する3重量%ジクロロエタン溶液を用いて、デ ィップコート法により、400nmの発光層を形成した。次 に、この発光層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板ホル ダーに固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に滅圧した。| さらに、発光層の上に、3-(4'-tertーブチルフェニル) ー4ーフェニルーー5ー (4" ーピフェニル) ー1. 2. 4ートリアゾールを、蒸着速度 O. 2nm/sec で20nm の厚さに蒸着した後、さらにその上に、トリス(8-キノリ ノラート) アルミニウムを、蒸着速度 O. 2 n m/sec で 3 Onmの厚さに蒸着し電子注入輸送層とした。さらにその上 に、マグネシウムと銀を蒸着速度 O.2nm/sec で200 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機 電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を 保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰 囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、74mA/c m² の電流が流れた。輝度1280cd/m² の白色の発光 が確認された。

nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm, making use of neutral detergent, acetone and ethanol, substrate was dried making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozoneafter washing, after locking in substrate holder of vapor deposition equipment, vapor deposition tankthe vacuum was done in 3 X 10-6 Torr . First, on ITO transparent electrode, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did compound (1 -10), in thethickness of 55 nm, made luminescent layer. Next, on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 1,3 - bis (5 - (p - t-butyl phenyl) - 1,3,4 oxadiazole -2'-yl) benzene, in thickness of 75 nm, made electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and thesilver in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor depositiontank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 15V, current of 68 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 1150 cd/m2 was verified.

[0061] Working Example 2.2

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm making use of neutral detergent, acetone and ethanol. It dried substrate making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozonewashed. Next, on ITO transparent electrode, luminescent layer of 400 nm was formed poly N - vinyl carbazole (weight average molecular weight 150000) and the 1,1,4,4 - tetra phenyl - 1,3 butadiene (light emission component of blue), making use of 3 wt% dichloroethane solution which contains the courarin 6 ("3 -(2' - benzo thiazolyl) - 7-di ethylamino coumarin " (light emission component of green color)), and compound (1-5), at ratio of respective weight ratio 100:5:3:2, with dip coating method. Next, after locking glass substrate which possesses this luminescent layer, in substrate holderof vapor deposition equipment, vapor deposition tank vacuum was done in 3 X 10-6 Torr . Furthermore, on luminescent layer, 3 - (4' - t-butyl phenyl) - 4 - phenyl - - 5 - (4" - biphenyl) - 1,2,4 - triazole, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec in thethickness of 20 nm vapor deposition after doing, furthermore on that, with the vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did tris (8 - quinolinolato) aluminum, in thickness of 30 nm andmade electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and thesilver in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor depositiontank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of

[0062] 実施例23

厚さ200mmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基 板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄 した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オ ゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上に、ポリーNーピニ ルカルパゾール(重量平均分子量 1 5 0 0 0 0) 、 1. 3 -ピス [5' - (p-tert-ブチルフェニル) - 1, 3, 4-オキサジアソールー 2'ーイル] ベンゼンおよび化合物(1 -35) を、それぞれ重量比100:30:3の割合で含有 する3重量%ジクロロエタン溶液を用いて、ディップコート 法により、300mmの発光層を形成した。次に、この発光 層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定し た後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。さらに、発光 層の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 O. 2 n m/sec で200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極と し、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素 子に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加したところ、 7 6 m A / c m² の電流が流れた。輝度 1 3 6 0 c d / m² の赤橙色の発光が確認された。

【0063】比較例3

実施例23において、発光層の形成に際して、化合物(1-35)の代わりに、1、1、4、4ーテトラフェニルー1、3ーブタジエンを使用した以外は、実施例23に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界素子に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加したところ、86mA/cm²の電流が流れた。輝度680cd/m²の青色の発光が確認された。

【0064】実施例24

厚さ200 n mの1 T O透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、 さらに U V / オン洗浄した。次に、 I T O透明電極上に、 ポリカーボネート(重量平均分子量50000)、 4. 4 ーピス [N-1] に [N-1]

12V, current of 74 mA/cm2 flowed. light emission of white of luminance 1280 cd/m2 was verified.

[0062] Working Example 23

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm, making use of neutral detergent, acetone and ethanol. It dried substrate making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozonewashed. Next, on ITO transparent electrode, luminescent layer of 300 nm was formed making use of the poly N - vinyl carbazole (weight average molecular weight 150000), 1,3 - bis (5'-(p-tbutyl phenyl) - 1,3,4 - oxadiazole - 2'-yl) benzene and 3 wt% dichloroethane solution which contains compound (1 - 35), at ratio of respective weight ratio 100:30:3, with dip coating method. Next, after locking glass substrate which possesses this luminescent layer, in substrate holderof vapor deposition equipment, vapor deposition tank vacuum was done in 3 X 10-6 Torr . Furthermore, on luminescent layer, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesiumand silver, in thickness of 200 nm, it made cathode, producedthe organic electroluminescent element. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 15V, current of 76 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 1360 cd/m2 was verified.

[0063] Comparative Example 3

In Working Example 2 3, at time of formation of luminescent layer, other thanusing 1,1,4,4 - tetra phenyl - 1,3 - butadiene in place of compound (1 - 35), organic electroluminescent element was producedwith method which is stated in Working Example 2 3. In organic electric field element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 15V, current of 86 mA/cm2 flowed. light emission of blue of luminance 680 cd/m2 was verified.

[0064] Working Example 2 4

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm,making use of neutral detergent, acetone and ethanol. It dried substrate making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozonewashed. Next, on ITO transparent electrode, luminescent layer of 300 nm was formed polycarbonate (weight average molecular weight 50000) andthe 4, 4'-bis (N-phenyl-N-(3"-methylphenyl) amino) biphenyl, making use of bis (2-methyl-8-quinolinolato) aluminum - oxo-bis (2-methyl-8-quinolinolato) aluminum and 3 wt% dichloroethane solution which contains compound (1-7), atratio of respective weight ratio 100: 40: 60:1, with dip

着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3×10⁻⁶ Torr に減圧した。さらに、発光層の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2 nm/sec で200 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、15 Vの直流電圧を印加したところ、66mA/cm²の電流がに流れた。輝度1070cd/m²の赤橙色の発光が確認された。

【0065】実施例25

ガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した。次に、ガラス基板上に、化合物(1-1)を、蒸着速度0.2 nm/secで100 nmの厚さに蒸着した。その上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2 nm/secで200 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とした。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。その後、陰極上にスコッチテープを張り付けた後、スコッチテープを剥離したところ、陰極と共に、化合物(1-1)の薄膜もガラス基板から剥離し、陰極との密着力は良好であることが判明した。

【0066】比較例4

実施例25において、化合物(1-1)の代わりに、1.3.5,7.8-ペンタメチルー4.4-ジフルオロー4ーボラー3a.4a-ジアザーsーインダセンを使用した以外は、実施例25に記載の方法により陰極を蒸着した薄膜を作製した。その後、陰極上にスコッチテープを張り付けた後、スコッチテープを剥離したところ、陰極と1.3.5,7.8-ペンタメチルー4.4-ジフルオロー4ーボラー3a.4a-ジアザーsーインダセンの薄膜の間で剥離し、陰極との密着力は不良であることが判明した。

[0067]

【発明の効果】本発明により、発光輝度が優れた有機電界発 光素子を提供することが可能になった。

【図面の簡単な説明】

【図1】有機電界発光素子の1例(A)の概略構造図である

coating method. Next, after locking glass substrate which possesses this luminescent layer, in substrate holderof vapor deposition equipment, vapor deposition tank vacuum was done in 3 X 10-6 Torr. Furthermore, on luminescent layer, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesiumand silver, in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 15V, current of 66 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 1070 cd/m2 was verified.

[0065] Working Example 2 5

Ultrasonic cleaning it did glass substrate, making use of neutral d etergent, acetone and the ethanol. It dried substrate making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozonewashed. Next, on glass substrate, compound (1 - 1), with vapor deposition rate 0. 2 nm/sec vapor deposition was done inthe thickness of 100 nm. On that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and silver, inthe thickness of 200 nm, it made cathode. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor depositiontank was maintained. after that, after attaching Scotch tape on cathode, the Scotch tape when it peels off, with cathode, also thin film of compound (1 - 1)peeled off from glass substrate, as for adhesive force of cathode beingsatisfactory was ascertained.

[0066] Comparative Example 4

In Working Example 2 5, other than using 1,3,5,7,8 - pentamet hyl -4,4-di fluoro -4 - bora - 3a,4a-di aza -s - indacene in place of compound (1 - 1), thin film which cathode vapor deposition isdone was produced with method which is stated in Working Example 2 5. after that, after attaching Scotch tape on cathode, the Scotch tape when it peels off, it peeled off between thin film of cathodeand 1,3,5,7,8 - pentamethyl - 4, 4-di fluoro - 4 - bora - 3a,4a-di aza - s - indacene, as for adhesive force of the cathode being a deficiency was ascertained.

[0067]

[Effects of the Invention] With this invention, it became possible to offer organic electroluminescent element where light emission luminance superior.

[Brief Explanation of the Drawing(s)]

[Figure 1] It is a outline structural diagram of 1 example (A) of organic electroluminescent element.

ISTA's Paterra(tm), Version 1.5 (There may be errors in the above translation. ISTA cannot be held liable for any detriment from its use. WWW: http://www.intlscience.com Tel:800-430-5727)

【図2】有機電界発光素子の1例(B)の概略構造図である

【図3】有機電界発光素子の1例(C)の概略構造図である

[図4] 有機電界発光素子の1例(D)の概略構造図である

【図5】有機電界発光素子の1例(E)の概略構造図である

【図6】有機電界発光素子の1例(F)の概略構造図である

【図7】有機電界発光素子の1例(G)の概略構造図である

【図8】有機電界発光素子の1例(H)の概略構造図である

【符号の説明】

1:基板

2:陽極

3:正孔注入輸送層

3 a:正孔注入輸送成分

4:発光層

4 a:発光成分

5:電子注入輸送層

5":電子注入輸送層

5 a: 電子注入輸送成分

6:陰極

7:電源|

[Figure 2] It is a outline structural diagram of 1 example (B) of o rganic electroluminescent element.

[Figure 3] It is a outline structural diagram of 1 example (C) of o rganic electroluminescent element.

[Figure 4] It is a outline structural diagram of 1 example (D) of organic electroluminescent element.

[Figure 5] It is a outline structural diagram of 1 example (E) of o rganic electroluminescent element.

[Figure 6] It is a outline structural diagram of 1 example (F) of o reanic electroluminescent element.

[Figure 7] It is a outline structural diagram of 1 example (G) of o rganic electroluminescent element.

[Figure 8] It is a outline structural diagram of 1 example (H) of organic electroluminescent element.

[Explanation of Reference Signs in Drawings]

1: Substrate

2: Anode

3: Positive hole injection transport layer

3a: Positive hole injection transport component

4: Luminescent layer

4a: Light emission component

5: Electron-implanted transport layer

5": Electron-implanted transport layer

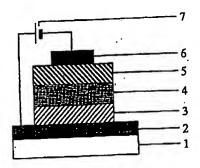
5a: Electron injection transport component

6: Cathode

7: Power supply

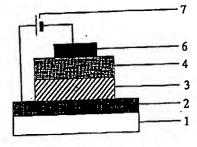
[図1]|

[Figure 1]



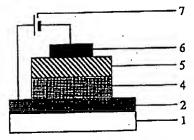
【図2】|





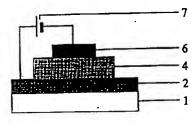
[図3]|

[Figure 3]



【図4】|

[Figure 4]



4 (4 a+5a)

2

